UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES CUAUTITLAN

DETERMINACIÓN DE LA CONDUTIVIDAD EN OXIDOS DE CROMO CON IMPLANTACIONES

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE QUIMICO PRESENTA

161

ROBERTO MONROY LOPEZ

DIRECTOR DE LA TESIS Dr. WILLIAM PICKIN CH.



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DIRECTOR TECNICO... Dr. STEPHEN MUHL S.

"INDICE"

G.

		PA
PREFACIO		1
CAPITULO	I	
1.1	INTRODUCCION GENERAL	1
1.2	OBJETIVOS DE LA TESIS	4
CAPITULO	Π	
2.1	CLASIFICACION DE LA CORROSION	6
2.2	CORROSION DE CROMO Y SUS ALEACIONES	7
2.3	ASPECTOS TEORICOS	8
	2.3.1. TIPOS DE OXIDOS	1
	2.3.2. CONDUCTIVIDAD POR DEFECTOS	1
2.4	CONCLUSIONES	1
CAPITULO	Ш	
3.1	INTRODUCCION	2
3.2	OBTENCION Y PREPARACION DE MUESTRAS	2
3.3	IMPLANTACION IONICA	2
3.4	ANNEALING	24
3.5	OXIDACION	24
3.6	MEDICION DE ESPESOR POR REACCION NU- CLEAR	24
3.7	OTRAS MEDICIONES	2(
3.8	ANALISIS DE RESULTADOS	

PAG.

9

6

CAPITULO IV

4.1	CARACTERISTICAS CORRIENTE-VOLTAJE (I-V)	29
	4.1.1. CONVENCION DE SIGNOS	- 31
4.2	CIRCUITO GLOBAL	52
4.3	PROBLEMAS EXPERIMENTALES	52
	4.3.1. SOLUCION AL PROBLEMA DEL VOL- TIMETRO	54
	4.3.2. MEDICION DE CORRIENTE	56
4.4	CONTACTOS A LA MUESTRA	58
	4.4.1. ELECCION DEL ELECTRODO	59
	4.4.2. MONTAJE DE LOS CONTACTOS	60
4.5	ARREGLO EXPERIMENTAL, DISEÑADO PARA ESTUDIAR LA REACCION QUIMICA	63
4.6	SISTEMA DE VACIO	67
4.7	EFECTO DE LA TEMPERATURA	70
CAPITULO	Υ.	
5.1	RESULTADOS PARA VOLTAJES APLICADOS MENORES DE 3 VOLTS QUE NO PRESENTAN REACCION QUIMICA	72
5.2	RESULTADOS OBTENIDOS EN EXPERIMENTOS CON OCURRENCIA DE LA REACCION QUIMICA	10
CAPITULO	VI (DISCUSION Y CONCLUSIONES)	
6.1	EN AUSENCIA DE LA REACCION QUIMICA	13
6.2	REACCION QUIMICA	14

6.3 SUMARIO DE LAS CONCLUSIONES	165
CAPITULO VII	
FUTUROS TRABAJOS	107
APENDICE "A"	
IMPLANTACION IONICA	177
APENDICE "B"	
MEDICION DE ESPESOR DE CAPA DE OXI	(DO
POR REACCION NUCLEAR INDUCIDA	18
POR REACCION NUCLEAR INDUCIDA	18
POR REACCION NUCLEAR INDUCIDA APENDICE "C" ELECTROMETRO KEITHLEY 602	18
POR REACCION NUCLEAR INDUCIDA APENDICE "C" ELECTROMETRO KEITHLEY 602 DESCRIPCION DE TABLAS	18
POR REACCION NUCLEAR INDUCIDA APENDICE "C" ELECTROMETRO KEITHLEY 602 DESCRIPCION DE TABLAS REFERENCIAS	18 19 19 20

"CAPITULO I"

1.1. INTRODUCCION GENERAL.

En esta tesis se trata de determinar las propiedades eléctricas de óxidos producidos por la corrosión de cro mo y sus aleaciones en altas temperaturas; con un enfoque que per tenece principalmente al área de la ciencia, conocida como "Cien-cia de la Corrosión" pero con enlaces fuertes con la Física y la -Química del Estado Sólido.

La ciencia de la corrosión apenas se está reconociendo como ciencia. Empezó ésta a estudiarse en el siglo-XIX cuando se construyeron los primeros barcos de hierro en la marina británica. Por el hecho de estar siempre en contacto con agua salada, sufrieron rápidamente el ataque de la corrosión. Este acontecimiento impulsó los primeros estudios cuantitativos sobre la corrosión de metales.

La importancia económica que representan los procesos de corrosión es apreciable, por ejemplo: para los Estados Unidos en el año de 1975, las pérdidas se estimaron del orden de US \$70 x 10^9 , según reporte del N. B. S. (National Bureau of Standards), en el Reino Unido para 1971, se estimaron las pérdi das en £ 1365 x 10^6 , según informe del Comité Hoar (nombrado por el Gobierno del Reino Unido para investigar estas pérdidas). Para México, las pérdidas se podrían estimar en MN $$50 \times 10^9$, calculado según:

costo para México \simeq costo en Estados Unidos x <u>PN B (MEX)</u> PN B (E. U.)

A pesar de la importancia económica que re presenta la corrosión, no había recibido un apoyo comparable con, por ejemplo, el recibido por la Física de los Semiconductores. Esta se impulsó hace unos treinta años con el descubrimiento del transistor y ha crecido con gran ritmo desde entonces. El problema de la corrosión no se había atacado por la poca importancia que se le concedió; esto era debido al bajo costo de las materias primas. Actualmente las materias primas son caras; en esta época se está impulsando el desarrollo de la Ciencia de la Corrosión, siendo la finalidad de esta ciencia el mejoramiento de los recursos naturales no renovables, por ejemplo, por medio de aleaciones resistentes a la corrosión, que permitan disminuir las pérdidas de grandes volúmenes de materias primas.

La Ciencia de la Corrosión se tiene que desarrollar por medio de teorías, debido a que si bien es rica en resultados experimentales, estos no están bien sistematizados, --(probablemente porque los variables no están bien identificados).

Sin embargo, se requiere de muchos trabajos experimentales; por ejemplo:

- Experimentos sistematizados para comprobar las mismas teorías.
- Rehacer los antiguos experimentos, tomando en cuenta las nue vas variables.

Estos trabajos pueden aprovechar las técnicas sofisticadas ya desarrolladas en la física de los semiconductores; correspondientemente se ha notado en años recientes cierto interés en los óxidos por parte de los físicos que trabajan en semiconductores, pero muchas veces sin considerar expresamente los problemas de la corrosión.

Los campos principalmente involucrados -

en el estudio de las propiedades de los óxidos son la Física y la -Química del estado sólido. La física del estado sólido se divide en tres campos: metales, semiconductores y aislantes. La rama más importante es la de los aislantes, debido a que los óxidos son aislantes. Sin embargo, los otros campos también entran, puesto que:

a) Lo que se corroe es un metal.

 b) Muchas de las técnicas usadas se desarrollaron primero conreferencia a los semiconductores. La Química del estado sólido está ampliamente relacionada con la oxidación, porque la formación de los óxidos propiamente es una reacción química (entre una fase sólida y un gas). Básicamente la reacción que ocurre en cromo a alta temperatura es:

 $4 \operatorname{Cr} + 30_2 \quad ---2 \operatorname{Cr}_2 0_3^{(2)}$

Una reacción adicional de oxidación de cromo en estado + 3 a unestado + 6, se describe en el transcurso de la presente tesis.

1.2. OBJETIVO DE LA TESIS.

La presente ^tesis continua con los trabajos efectuados recientemente ^(3, 4; 5 y 6) (1977) por:

G. Dearnaley - de la AERE (Atomic Energy Research Establish-ment) de Harwell.

R. A. Collins - de la Universidad de Lancaster.

S. Muhl - de la Universidad de Lancaster.

Estos estudios se llevaron a cabo sobre la oxidación de muestras de cromo que habían sido sujetos a un tratamiento de implantación iónica, siendo estas muestras implantadas en ciertas regiones de la superficie con elementos de transición y otros metales; la implanta_ ción permite tener una aleación de composición perfectamente controlada. Después de la implantación, dichas muestras fueron oxida_ das a 750°C. en atmósfera de oxígeno seco. En el presente trabajo, se utilizaron estas muestras que se prepararon en Inglaterra. Dicho trabajo se llevó a cabo en la Sección de Investigación del Departamento de Física de la ENEP Cuautitlán.

Lo que nosotros estudiamos es la conducta eléctrica de las capas de óxido de estas muestras; tanto fuera de la región implantadas como dentro de esta región. Se espera que, con el tiempo, el entendimiento de la conducta eléc trica de las muestras oxidadas permita conocer más a fondo los mecanismos de corrosión y buscar alguna forma o técnica que nos permita disminuir los efectos de la corrosión.

Los objetivos del presente trabajo son: 1.- Obtener datos experimentales confiables, sobre las propiedades eléctricas de las capas de óxido de cromo y sus aleaciones, siendo estas capas formadas por corrosión, y

- Hasta donde sea posible, sugerir teorías que expliquen los re sultados obtenidos.
- 3.- El objeto final de los trabajos de los cuales el presente forma parte, es sugerir nuevas aleaciones de cromo para uso industrial, que reduzcan el costo de las pérdidas antes mencionadas.

"CAPITULO II"

2.1 CLASIFICACION DE LA CORROSION.

Al hablar de la corrosión, por la experiencia cotidiana, la relacionamos casi inmediatamente a un proceso que se lleva a cabo en un medio húmedo, pero existe un tipo de corrosión que no es en un medio húmedo; por lo cual, la corrosión se clasifica en la siguiente forma:

- a) Corrosión en húmedo.
- b) Corrosión en seco.

La corrosión en húmedo. - Como su nombre lo indica, es aquella que requiere de un medio acuoso; para su explicación se relaciona con un proceso electroquímico y los pro-ductos de la reacción pasan a formar parte de la solución. Este último . aspecto. la distingue del tipo de corrosión estudiada en la presente tesis.

La corrosión en seco.- Se efectúa en au sencia de agua. Por lo que este tipo de corrosión adquiere impor tancia al efectuarse a temperaturas superiores a los 100°C. En este tipo de corrosión los productos de reacción se adhieren a la superficie del metal e impiden que la corrosión se propague con un desgaste continuo de material.

En esencia, corresponde a una oxidación del metal. Sin embargo,

cabe mencionar que pequeñas cantidades de contaminantes en la atmosfera afectan en forma desproporcionada este tipo de corrosión.

2.2. CORROSION DE CROMO Y SUS ALEACIONES.

En nuestro caso particular de investigación,

las muestras fueron oxidadas en una atmósfera de oxígeno seco.⁽⁴⁾ Las muestras fueron de cromo, que es un metal de importancia en aleaciones industriales, siendo un componente de aceros inoxidables. Las aleaciones de cromo con hierro para usos específicos son:^(5y 6)

Fe-C-Cr-V-W

se usa en herramientas térmicas "perfec_ tas".

Fe-C-Si-Cr-V-W se usa en punzones para perforar en caliente.

Fe-C-Cr-Me-V se usa en tuercas y remaches.

Fe-C-Si-Cr-Mo-W se usa en construcción de maquinaria.

Fe-C-Si-Cr-Mo-V se usa en construcción de núcleos metálicos.

Fe-C-Cr-Mo-Ni-V se usa en grabados profundos.

Fe-Cr-Al(Fecralloy es una de las últimas aleaciones de mayor im portancia industrial).⁽⁷⁾

Aleaciones de cromo que no contienen

hierro son:

Co-Cr;Co-Cr-Al;

Ni-Cr- (Nicromel se usa en resistencias para trabajar a tempera

turas de hasta 800°C)

Ni-Cr-Al (Cromel se usa en termopores de alta temperatura (1150°

C) en atmósfera oxidante limpia. $(^{(8)})$.

El óxido cromoso $(Cr_2 0_3)$ es el producto de oxidación de dichas aleaciones al sufrir una oxidación térmica.

En la tabla 1 se presentan datos sobre cro mo y los óxidos de cromo son obtenidos de la Literatura.

2.3. ASPECTOS TEORICOS.

1.

2.

El problema de la corrosión de un metal es que en presencia de oxígeno y alta temperatura tiende a oxidarse.

La corrosión se inicia con la formación de la primera mono capa de oxígeno en la superficie de metal.

No hay problema en comprender este primer paso de oxidación, donde depende de los fenómenos de fisiadsorción y qui miadsorción, ya bien estudiados.⁽⁹⁾

El problema es entender cómo se puede seguir creciendo la capa de óxido ya formada, ya que la capa por naturaleza se para los reactivos (metal y oxígeno) uno de otro.

Obviamente el crecimiento de la capa de

óxido tiene que darse por movimiento iónico através de la capa de óxido.

Los movimientos pueden ser de iones de oxígeno hacia el interior o de iones metálicos hacia el exterior.

Este movimiento de iones se debe casi por definición a defectos en la capa de óxido.

Los defectos se pueden dividir en dos cla

ses:

a) Microscópicos

b) Macroscópicos

 a) Los defectos microscópicos más comunes son las vacancias, intersticiales, dislocaciones y fronteras entre granos.
 b) Los defectos macroscópicos son los rayones, hoyos y fracturas.

Las vacancias⁽¹⁰⁾, (11) y (12) son defec-

tos punto, que corresponden a la deficiencia de un átomo en la red cristalina.

La vacancia tiende a ser ocupada por los átomos de la red, por lo que se origina que la vacancia ocupe un sitio diferente al anterior. Al que la vacancia se pueda encontrar en sitios diferentes se cono ce como movimiento de vacancias. La vacancia se desplaza en - sentido opuesto al movimiento de los átomos de la red. Fig. 1

Otro defecto punto son los intersticios ---(10) y (11), para este caso se presentan átomos en la red ajenos a la estructura y que se alojan en los huecos formados por el arreglo tridimensional que se conocen como intersticios. Un ión intersticial puede moverse a intersticios adyacentes. Ver Fig. 2

Las dislocaciones ⁽¹³⁾ son defectos de línea; se tiene una línea de espacio extra en la red cristalina debido a la falta de medio plano de átomos; las dislocaciones pueden considerarse como conductos por donde los iones se pueden desplazar. Ver Fig. 3

Las fronteras entre granos ⁽¹³⁾ se conocen como defectos en dos dimensiones; las fronteras entre granos presentan espacios que son conductos fáciles para el movimiento de iones. Fig. 4

Los rayones, hoyos y fracturas, son defectos complejos, pero se consideran como fuentes continuas de io nes.⁽³⁾

Existen dos posibles "fuerzas" que pueden generar los movimientos iónicos necesarios para la oxidación. a) Primero, existe el fenómeno de difusión, con el que se en



Figura 1. Una vacancia en un cristal; se indica su forma de movi

miento.



Figura 2. Un stersticial en un cristal; se indica su forma de mo-

11

vimiento.

Figura 3.. Un ejemplo de una dislocación en un cristal; la disloca ción es una línea perpendicular al plano de la figura que pasa por el punto "A".

Figura 4.

El linde entre los granos de un cristal. En esta figura el ángulo θ es pequeño y el defecto consiste de una serie de dislocaciones.

En casos en que el ángulo θ es grande existe mucho es pacio entre los granos, por el cual otros átomos pueden difundirse.

cuentra familiarizado todo químico; en este proceso se debe de tener una diferencia de concentraciones de iones; la corriente de iones generado es proporcional, en casos sencillos, a la pendiente de la concentración.

 b) Segundo, existe la probabilidad de que durante del crecimiento de una capa de óxido la fuerza ejercida sobre los iones previene de campos eléctricos internos generados por cargas en la superficie del óxido y en la interfase metal-óxido.

2.3.1. TIPOS DE OXIDOS.

Los óxidos son en general materiales con falta de estequiometría, y se pueden clasificar en la siguiente forma.(14)

- a) Oxidos con deficiencia de oxígeno, con vacancias aniónicas, por ejemplo: Nb₂0₅ y Zn0₂.
- b) Oxidos con exceso de oxígeno, con aniones intersticiales, por ejemplo: V02
- c) Oxidos con deficiencia de metal, con vacancias catiónicas por ejemplo: Ni0, Fe0 y (de interés para la presente tesis) Cr_20_3
- d) Oxidos con exceso de metal, con cationes intersticiales, por ejemplo: Zn0

2.3.2. CONDUCTIVIDAD POR DEFECTOS.

La presencia de defectos en un cristal tiene una gran influencia sobre la conductividad eléctrica del cristal.

Por una parte los defectos mismos poseen normalmente carga eléctrica y entonces su movimiento en el cristal corresponde a un flujo de corriente iónica en el cristal, en este sentido se puede hablar de un cristal con "conductividad iónica". Pero también la presencia de defectos afecta muchísimo las concentraciones de electrones y (Electrón) huecos que son portadores de corriente eléctrica en el cristal y que contribuyen a la conductividad electrónica del cristal. Este aspecto del efecto de los defectos requiere de más explicación:

Es por todos bien conocido que en un cristal (no metálico) de absoluta limpieza (si. tal cosa pudiese existir) la concentración de electrones móviles (en la banda de con ducción) sería idéntica a la concentración de huecos móviles (en la banda de valencia). Esto es porque cada electrón en la banda de conducción ha salido por definición de la banda de valencia del cristal y ésta entonces padece una deficiencia de este electrón, que es por definición un hueco. En un material aislante en temperatura de ambiente estas concentraciones de electrones y huecos

serán, además de ser iguales, casi nulas. En cambio en un cristal con defectos que son iones positivos (casos (a y d) de la clasificación de los óxidos) se espera que habrá mucho más electrones que huecos, porque los electrones móviles no han sido proporciona dos por la banda de valencia del cristal puro, sino por los mismos defectos (y por eso los defectos tienen carga positiva, por haber perdido electrones). Un tal cristal se llama "del tipo n", terminología que proviene de la física de los semiconductores. Un cristal con defectos que son iones negativos tendrá en forma correspondien te mucho más huecos que electrones, y se llama "del tipo p". En sumario existen fuertes enlaces entre la conducción electrónica y las concentraciones de defectos en un cristal.

En casos sencillos las concentraciones de defectos en un cristal en equilibrio termodinámico pueden ser calculados por métodos esencialmente químicos (10 y 11). En este método procesos de formación e iniquilación de defectos se tratan como reacciones químicas; por ejemplo, consideremos una reacción en un cristal iónico MX (M=metal) en donde se crean un ión metálico intersticial M_i + (carga positiva) y correspondientemente una va cancia metálica en la red V_m^- con carga negativa, a partir de --la situación en que el átomo metálico M estuvo en su sitio correc to, situación denotada por M_m . (El subíndice indica el sitio en

esta notación). La fórmula para esta reacción es:

$$V_i + M_m = M_i^+ + V_m^-$$

(" V_i " significa una "vacancia en sitio intersticial", introducida por fines teóricos). Aplicando las leyes de reacciones químicas, y su poniendo que las concentraciones en equilibrio $\begin{bmatrix} M_i^+ \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} V_m^- \end{bmatrix}$ de los defectos son mucho menores que las concentraciones de átomos en sitios correctos, obtenemos:

$$\begin{bmatrix} M_i^+ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_m^- \end{bmatrix} = K$$

En donde K es la constante de la reacción (que será proporcional a exp $(-\Delta E/RT)$ en donde ΔE es el cambio de energía libre). Este tipo de teoría se encuentra bien desarrollada en la química del estado sólido. Sin embargo, su aplicación es muchas veces limitada por falta de información experimental sobre los valores de las constantes de reacción y por diferencias entre la situación experimental y la situación ideal tratada por la teoría, (como en nue<u>s</u> tro caso).

Puesto que la formación e iniquilación de defectos es difícil excepto a altas temperaturas, la concentración de defectos en un cristal que ha sido sometida a alta temperatura no es normalmente la apropiada para lograr el equilibrio a la temperatura del ambiente, sino más cerca de la apropiada para la alta temperatura. En el caso de los óxidos estudiados en la

presente tesis, es difícil predecir teóricamente su grado de estequiometría o las concentraciones de defectos que pudieran contener.

- a) Esto es porque las condiciones que operaron durante el crecimiento distan mucho de las condiciones de equilibrio especificadas en las teorías; existe un estanque de metal, con superfície dañada, y durante el proceso de crecimiento ocurren por necesidades del crecimiento flujos de defectos.
- b) Se cree ⁽¹⁵⁾ que el óxido de cromo Cr203 producido por corrosión en seco en altas temperaturas es en general deficien te en cromo y entonces es un óxido del tipo p. Sin embar go, se supone que esta situación será diferente para la parte de óxido que está cerca de la interface metal-óxido; esta par te debe contener un exceso de metal y debe ser un óxido del tipo n.

Se nota entonces que es de esperarse que el óxido producido por corrosión contenga "uniones p-n", es decir, regiones en donde el tipo del óxido se cambia del tipo p al tipo n, debido a los cambios en los defectos predominantes del óxido. Las propiedades eléctricas de una tal unión p-n son conocidos en la física de los semiconductores; este tipo de unión constituye undiodo, un dispositivo electrónico que pasa corriente preferencialmen te en una sola dirección. Se espera entonces que las propiedades eléctricas de las capas de óxido estudiadas en la presente Tésis d<u>e</u> ben ser complejas, demostrando por lo menos asimetría; si se hace fluir una corriente entre la interfase metal-óxido y la interfase óxido-aire, se espera que esta corrienta fluya más fácilmente en un sentido que en otro. Cabe mencionar también que en una unión p-n existe un campo eléctrico interno, puesto que se ha hipotetiza do que campos internos son responsables del crecimiento de óxido, durante la corrosión.

2.4 CONCLUSIONES.

Se concluye de este capítulo:

- a) Que existe relación entre las propiedades conductivas, tanto electrónicas como iónicas, de las capas de óxido producidas por corrosión en seco y las concentraciones de defectos presentes en el óxido.
- b) (Más importante) que el crecimiento de la capa de óxido tie
 ne importantes aspectos eléctricos, siendo producido por cam
 pos eléctricos internos al óxido. Queda entonces claro que
 una condición indispensable para el entendimiento final y cuantitativo del proceso de corrosión en seco es lograr un -

entendimiento de las propiedades conductivas de las capas de óxido producidas. Queda igualmente claro que estas propiedades serán complejas y no explicadas en poco tiempo.

Este trabajo constituye un primer paso ha cia este entendimiento, presentando un bosquejo de las propiedades eléctricas más elementales de las capas de óxido producidas por la corrosión en seco de cromo y sus aleaciones.

entendimiento de las propiedades conductivas de las capas de óxido producidas. Queda igualmente claro que estas propiedades serán complejas y no explicadas en poco tiempo.

Este trabajo constituye un primer paso ha

19

cia este entendimiento, presentando un bosquejo de las propiedades eléctricas más elementales de las capas de óxido producidas por la corrosión en seco de cromo y sus aleaciones.

"CAPITULO III"

3.1 INTRODUCCION.

En este capítulo se describe la prepara-ción de las muestras y los resultados obtenidos en experimentos pr<u>e</u> vios sobre las muestras, llevados a cabo por el Dr. Muhl en la Universidad de Lancaster y AERE Harwell.⁽⁵⁾

(Este capítulo es necesario para entender el estado de las muestras y de nuestro conocimiento sobre ellas, al inicio del presente trabajo).

3.2 OBTENCION Y PREPARACION DE MUESTRAS.

Las muestras se obtuvieron a partir de una placa de cromo de 2 mm. de espesor; ésta se corta en cuadros de 10 mm. de lado y en círculos de un diámetro de 10 mm. La pureza del cromo era de 99.99%; el corte de la placa se efectuó por chispa eléctrica.

La preparación de cada muestra para los experimentos llevados a cabo en Inglaterra fue la siguiente:

- a) Se lavó inicialmente con agua desionizada.
- b) Se pulió una de las superficies de cada muestra, primero -

con carborundum de tamaño promedio de grano de 30 micras, después sucesivamente con pasta de diamante de tamaño de grano de 14, 9, 5, 3, 2, 1 micras, respectivamente, hasta que se obtuvo una superficie lisa.

Se lavó la muestra sucesivamente con agua desionizada, detergente, alcohol isopropílico y otra vez con agua desionizada (este tratamiento es con la finalidad de eliminar la grasa introducida por el paso b).

Se pulió la muestra electroquímicamente en una solución de ácido acético, ácido perclórico y glicerol.

La capa dañada por el diamante fué removida por un proceso electroquímico; al final de estos pasos la su -perficie tratada quedó lisa y perfecta.

3.3. IMPLANTACION IONICA.

c)

d)

En una región céntrica de cada muestra se formó una aleación de cromo con otro elemento. El proceso de aleación se logró por la técnica moderna de implantación ióuica haciendo incidir sobre la muestra un haz de iones del otro elemento. La profundidad a la que logran penetrar estos iones es del orden de 1 micra. Esta técnica se describe en el apéndice A.

Los elementos con que se hicieron las implantaciones se enuncian en la columna 1 de la tabla 2 donde se indica también otros datos de las implantaciones. Unas muestras fueron implantadas dos veces, con elementos diferentes; dichas - muestras presentan dos regiones céntricas de implantación como se indica en la fig. 5, presentando cuatro regiones diferentes en la -muestra.

La ventaja del método es que la cantidad del elemento implantado se conoce con gran precisión (por integrar la corriente del haz sobre el tiempo de implantación). Pero la aleación producida no constituye una solución sólida del otro elemen to en cromo que se encuentra en equilibrio termodinámico, en cam bio, el proceso produce daños en la región implantada y se espera que la mezcla de cromo y elemento implantado está bajo considera ble tensión por la presencia de átomos extraños en la red cristalina del cromo; los átomos extraños se alojan en sitios intersticiales del cromo y en fronteras entre granos.

Unas muestras se implantaron con iones de cromo (se tiene entonces el sistema cromo-cromo implantado), con la finalidad de estudiar en una forma aislada el efecto que oc<u>a</u> sionó el daño.



Figura 5. Una nuestra de cromo después de sufrir el tratamiento de implantación iónica; en este caso la muestra recibió dos implantaciones y se pueden distinguir cuatro regiones distintas:

A Región no implantada

B Región implantada, con la 1^a. implantación
C Región implantada, en la 2a. implantación.

D Región que recibió las dos implantaciones.
(Se excluye la región D en la definición de las áreas B y C).

3.4. "ANNEALING"

En algunas muestras se intentó reducir el

daño con un proceso de recocimiento ("annealing") hasta a 800°C durante un tiempo de 30 minutos en vacío. Este proceso se efec tuó con la finalidad de facilitar el movimiento de los defectos inters ticiales en la red cristalina del cromo, para permitir aniquilación de defectos. No se espera que la muestra después de sufrir el proceso de annealing llegue totalmente a un equilibrio termodinámico.

3.5. OXIDACION.

Después del proceso de implantación (y po siblemente annealing) las muestras fueron oxidadas en un horno a 750°C durante 20 minutos en una atmósfera de oxígeno seco. Después de la oxidación, el espesor de la capa de óxido era aproximadamente una micra en la región no implantada y menor en la región implantada.

3.6. MEDICION DE ESPESOR POR REACCION NUCLEAR.

La medición del espesor de la película

de óxido se logró en cada muestra dentro y fuera de la región implantada por la técnica de "reacción nuclear inducida" que se describe en el apéndice B.

En esencia se bombardeó la muestra con un haz de iones de deuterio; estos provocan reacciones nucleares con el oxígeno de la capa de óxido ocasionando la emisión de pro-tones con energías características de la reacción.

En el experimento se miden el número N de protones emitidos; puesto que este es proporcional a la cantidad de oxígeno presente en la región bombardeada, por lo tanto es proporcional al espesor de la capa de óxido en esa región.

En realidad el método es relativo y no absoluto, porque se desco-noce la constante de proporcionalidad.

Se obtienen valores de conteo (de protones) de $N_1 y N_2$ donde N_1 corresponde al número de cuentas dentro de la implantación y N_2 al número de cuentas fuera de la implantación y si los espesores - de las dos capas correspondientes son d_1 y d_2 entonces se pue- de deducir que:

 $d_1 / d_2 = N_1 / N_2$

3.7. OTRAS MEDICIONES.

A las muestras se les practicaron otras

mediciones más convencionales, tales como rayos X y microscopía electrónica.

También se llevaron a cabo unas pocas mediciones sobre las propiedades eléctricas de las capas de óxido, estableciéndose la posibi lidad y la necesidad del presente trabajo.

3.8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

El análisis de los resultados se expresó

en términos de un parámetro r (óxide ratio) de cada muestra r definido por:

$$r = d_i / d_s$$

en donde d_i es el espesor de la capa de óxido en la región implantada de la muestra y d_s es el espesor de la región no implantada. Esta variable expresa la inhibición de oxidación lograda por el proceso de implantación, por ejemplo, un valor de r de 0.1 se interpretó como una inhibición considerable y un valor de r de 0.9 como inhibición casi nula (valores mayores de 1 corresponden a un refuerzo de oxidación).

Las conclusiones de este trabajo fueron en gran parte negativas; no se podían detectar correlaciones claras entre r y (a) electronegatividad, (b) radio iónico, (c) potencial de oxidación, (d) calor de formación, o (e) el peso atómico de los elementos implantados.

Esto indica lo difícil que es trabajar en el área de corrosión en se co de cromo

Quedó claro que el proceso de implanta--

27

ción tiende a reducir el crecimiento de óxido y que esta reducción se encontró aún en el caso en que el elemento implantado fué el mismo cromo.

La reducción sí mostró correlaciones significativas con la energía de implantación de los iones y con la dósis total de implantación. Con la reducción de espesor de óxido se encontró también una reducción en el tamaño de los cristalitos de óxido y una mejor adh<u>e</u> sión del óxido a la superficie del cromo; en sumario el proceso de implantación es ventajoso en la protección de cromo contra la corrosión en seco.

Se sugirió que este efecto ventajoso de la implantación se debe a que (a) la tensión inducida en la superficie del cromo por la implantación reduce en efecto la tensión mencionada entre el cromo y el óxido y (b) la presencia de los átomos im plantados hace más difícil la acumulación de vacancias que de otro modo formarían huccos en la interfase cromo-óxido, tendiendo a -provocar desprendimiento de la capa de óxido.

En el caso de implantación de ciertos ele mentos se sugirió que su baja solubilidad en cromo causó acumulación de estos elementos en las fronteras entre los granos de metal en donde reaccionaran con el oxígeno para formar un componente que reduce la difusión del cromo por estas fronteras.

El efecto del tratamiento térmico de ----"annealing" era complejo; reforzó la inhibición para unas tempera turas del tratamiento y la redujo para otros.

Para implantación de cromo se puede explicar el efecto como una reducción efectiva en la dósis de la implantación, puesto que el objetivo del tratamiento es disminuir el grado de daño superficial.

"CAPITULO IV"

EXPERIMENTAL

4.1. CARACTERISTICAS CORRIENTE-VOLTAJE (I-V).

El experimento básico es obtener la carac terística I-V de la capa de óxido de cromo y también de la capa de óxido de la implantación.

Ejemplos de características I-V conocidas

son:

a)

b)

La característica I-V para una resistencia es una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es 1/R. Fig. 6 La curva que presenta un diodo es una curva asimétrica, d<u>a</u> da por la unión p-n. Fig. 7

En nuestro trabajo no se encontraron curvas tan simples de pronta explicación. Presentan la asimetría de un diodo, pero en forma mucho más compleja.

Existen otras características conocidas en

29

la física, las que demuestran "switcheo" ^(16 y 17). Dentro del switcheo podemos encontrar que éste es de dos tipos; tipo N y tipo S.
a) En el switcheo tipo S, se tiene más de una corriente para -


un solo voltaje. Fig. 8

b)

El switcheo tipo N, involucra que a dos voltajes diferentes,se tiene la misma corriente. Fig. 9

Por lo que se puede definir un switcheo como un efecto mul tivaluado en voltaje o corriente.

Se nota de las figuras 8 y 9 que el switcheo siempre involu cra resistencia negativa, en por lo menos una parte de la característica.

A causa de esta resistencia negativa los efectos de switcheo normalmente traen consigo inestabilidades de la corriente o voltaje y muchas veces ruido fuera de lo esperado. Los switcheos se presentan en varios dispositivos semiconductores.

Las capas de óxido de nuestros experimentos, presentan las características de switcheo, también en forma muy com pleja, pero son del tipo N como se muestra en las figuras 10 a 26.

4.1.1. CONVENCION DE SIGNO.

El voltaje se considera positivo si se aplica positivo a la capa de óxido en la interfase óxido-aire y negativo si se aplica positivo en la interfase óxido-metal.



Figura 8. Una característica I-V de un dispositivo que muestra switcheo tipo "S".

> Se nota que para un mismo voltaje se tienen varias posibles corrientes; la que fluye en un caso dado depende de que si el voltaje está aumentando o disminuyéndose; es decir, depende de la "historia" del dispositivo.



Figura 9. Una característica I-V que muestra switcheo tipo "N" se nota que para una misma corriente se tienen varios posibles voltajes.



Figura 10. Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{18} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 $\times 10^{-6}$ ampers.

34

Vin



Figura 11. Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{18} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0,5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers.



Figura 12. I

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{18} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10^{-6} ampers.



muestra V₁₈ bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers.



Figura 14. Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{14} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 $\times 10^{-6}$ ampers.



Figura 15.

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{14} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers. 39



Figura 16.

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{14} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10^{-6} ampers.



Figura 17. Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_{14} bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 $\times 10^{-6}$ ampers.



Figura 18.

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_9 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers.



Figura 19.

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_9 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers. 43



Figura 20. Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_9 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers.



de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5×10^{-6} ampers.



Figura 22.

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_9 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 $\times 10^{-6}$ ampers.





Figura 24.

Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_9 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers.



Figura 25. Las características I-V obtenidas en un punto de la -muestra V_9 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 7 volts, escala para voltaje de 1 in= 1 volt, escala para corriente de 1 in= 5 X 10⁻⁶ ampers.



Figura 26. Las características I-V obtenidas en un punto de la --

muestra V_5 bajo aplicación de un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 12.5 volts, escala para voltaje de 1 in= 5 volts, escala para corriente de 1 in= 5 X 10^{-7} ampers.

Nota: Se usa la misma clave en las muestras de los trabajos precedentes para no perder la secuencia de la investigación.

4.2. CIRCUITO GLOBAL.

Para obtener una característica I-V, es necesario aplicar un voltaje entre las dos superficies de la capa de óxido y medir la corriente que pasa através de la misma. El circuito general que se usó en todas las mediciones de la carac terística I-V de las muestras se presenta en la figura 27, donde:

F = fuente de fuerza electromotríz

A = medidor de corriente

V = medidor de voltaje

Los equipos F, A y V eran diferentes en diferentes experimentos. Se empieza por describir los experimentos hechos en C.D. para voltajes aplicados a la muestra de entre - 2 y + 3 volts. (Para voltajes más grandes negativos ocurre una reacción química en la muestra, que será descrita posteriormente).

Sin embargo, muchos de los problemas que se describen a continua ción, ocurrieron con otros experimentos efectuados.

4.3. PROBLEMAS EXPERIMENTALES.

El problema básico es la alta resistencia de las muestras, del orden de 1,000 M ohms. (Para voltajes me nores de 3 volts).



Figura 27. El tipo de circuito global, en todos los arreglos experimentales que se usaron para obtener características I-V.

900

NANUAMPRS Figura 28. 10 - 10

300

5

Variación con el tiempo de la corriente medida (por el electrómetro) al aplicar un voltaje de = 1 volt a la -muestra V_{11} , donde se nota el ruido que presentan las

capas de óxido.

600

Para empezar, a menos de que se apliquen voltajes muy grandes -(y se quiso investigar las propiedades para voltajes <3 volts) las corrientes serán pequeñas, 1V/10⁹ ohms = 1 nano-amper. Estas corrientes son difíciles de medir porque sen afectadas por ruidos -(Fig. 28) e interferencias de varios tipos.

También la resistencia del voltímetro tiene que ser mucho mayor en comparación con la de la muestra. Si no la es, la corriente puede pasar por el voltímetro en lugar de por la muestra; por lo tanto la corriente medida por el amperímetro, que es la corriente total del circuito, no será la corriente que se desea medir, (la que pasa por la muestra).

En estos experimentos:

F = primero fuente controlada, después pilas.

A = electrómetro Keithley, Modelo 602.

V = voltímetro de resistencia interna \sim 1,000 M ohms.

4.3.1. SOLUCION AL PROBLEMA DEL VOLTIMETRO.

El voltímetro de la figura 27 era de tipo

54

convencional, Modelo Simpson 460, de 3 1/2 dígitos.

Según el instructivo, su resistencia interna, que varía con el ran-

go, era "mayor de 10⁹ ohms", dato no suficientemente conclusivo para el fin del experimento.

Afortunadamente las demás condiciones del experimento, proponían una solución sencilla al problema de la resistencia interna del voltímetro.

Consideremos el circuito de la figura 27, donde el voltaje através de la muestra es simplemente el voltaje de la fuente, que es medi do correctamente por el voltimetro (la caída de voltaje através del amperimetro es despreciable, puesto que su resistencia interna es menor que la resistencia de la muestra o del voltimetro, ver apén dice C).

Se ve claro que el único error que podría causar el voltimetro, se ría afectar el valor de la corriente.

Pero con el voltimetro desconectado el voltaje en la muestra sigue siendo el valor ya medido, porque desconectar el voltimetro con una resistencia mayor de unos K ohms no puede afectar el voltaje de la fuente.

Pero ahora la corriente medida por el amperímetro tiene que ser la correcta, porque el voltaje no pasa por el voltimetro desconecta do y por lo tanto tiene que pasar por la muestra. En sumario el procedimiento correcto es:

a) Medir el voltaje aplicado a la muestra (la lectura del voltímetro).

desconectar el voltimetro y medir la corriente que pasa por la muestra (lectura del amperimetro).

Con este procedimiento no importa si la resistencia interna del voltímetro fuera algo menor que la de la muestra. El único error que se podría introducir sería si el voltaje de la fuente varía con el tiempo; tal error se puede reducir a nivel muy pequeño (en experimentos de corriente dirocta), por efectuar las dos mediciones en forma rápida, no dejando tiempo tal que el voltaje de la fuente varie.

Obviamente, este procedimiento, también sirve para confirmar si la resistencia del voltímetro es mayor o no que la resistencia de la muestra.

Si la lectura del amperimetro no cambia al desconectar el voltimetro, se deduce entonces que la resistencia interna de éste es la adecuada.

4.3.2 MEDICION DE CORRIENTE.

b)

En teoría, la medición de corrientes del orden de nano amprs, cae bien dentro de las capacidades del electrómetro Keithley, que mide hasta 10^{-15} amprs (como se logra esto, está descrito en el apéndice C).

Sin embargo; corrientes tan pequeñas están sujetas a varias in-fluencias tales como: ruidos, interferencias eléctricas, movimiento de personas y lluvia que ocasionan fluctuaciones considerables en las mediciones.

Una persona que escribe dentro del laboratorio a tres metros del equipo, es suficiente para imposibilitar las mediciones; en suma las técnicas experimentales desarrolladas tuvieron que ser más sofisticadas de lo que se creían.

Para solucionar estos problemas de interferencia, se construyó una JAULA DE FARADAY parcial, de papel aluminio forrando el laboratorio de trabajo.

También se blindaron los alambres del circuito usando cable coa-xial y aterrizando el blindaje.

Pese a todo esto, todavía había inestabili

dades.

Se decidió simplificar el circuito, por lo cual se reemplazó la fuen te por pilas, evitando así, variaciones posibles en la línea que alimentaba la fuente.

Para variar el voltaje aplicado al circuito, se conectó a la pila un divisor de voltaje, mostrado en la figura 29.

Sin embargo, éste también complicó el circuito, debido a que era afectado por cambios en la temperatura.

Finalmente, se eliminó, aceptando la restricción de trabajar a pocos valores de voltaje (múltiplos de 1.5 volts), a cambio de mejorar la estabilidad en las lecturas.

Las posibles modificaciones mencionadas, redujeron por mucho la inestabilidad pero no la eliminaron totalmen te.

La solución final de este problema, fue simplemente mucha paciencia; se debe notar que los resultados son entonces un promedio de las mediciones.

4.4. CONTACTOS A LA MUESTRA.

En todos los experimentos se tienen que

considerar los contactos eléctricos a la muestra.

Estos tienen que ser dos: uno a la parte metálica que soporta la capa de óxido, puliéndose el lado opuesto de la muestra que sufrió la implantación y las caras de las aristas de la muestra, para qui tar el óxido y dejar la superficie de cromo metálico, y el otro contacto sobre la capa de óxido.

No se tiene ningún problema con el contac

to de la parte metálica, esto se logra simplemente por presión con

tra las caras de las aristas, figura 30.

El contacto con la capa de óxido, fue mu-

cho más difícil.

La superficie de la capa de óxido, no es plana a nivel microscópi-co, sino presenta crestas y valles, lo cual también da diferencias en las lecturas de corriente, (a un voltaje fijo).

Si el electrodo se coloca en una cresta, se registra menor corrien te; si se coloca el electrodo en un valle, la corriente registrada es mayor.

Una de las posibles soluciones considera -

das, era usar mercurio (Hg), pero éste se rechazó de inmediato, por posible contaminación de la muestra si el mercurio entrara en la muestra, por posibles rayones o fracturas en la capa de óxido.

Finalmente, el contacto que se eligió, fue una punta de alambre; se formó en uno de sus extremos un gancho que descansó sobre la capa de óxido, figura 31.

4.4.1. ELECCION DEL ELECTRODO.

Inicialmente, se trabajó con cinco electro

dos, de oro, de plata, de cobre, de wolframio y de aluminio, encontrándose que los resultados varían de acuerdo al electrodo usado a la medición.

Esto no es de extrañarse, por haber una posible difusión del metal del electrodo en el área de contacto óxido-electrodo.

Los resultados más estables, los proporcionó el electrodo de oro, por lo cual se trabajó con él durante todo el experimento; para poder hacer esta elección se obtuvieron cerca de 150 características I-V con los cinco electrodos, de donde se descartaron los electrodos inadecuados.

4.4.2. MONTAJE DE LOS CONTACTOS.

Esta forma de hacer contacto con la mues tra, se incorporó en un dispositivo que tuvo que cumplir ciertos re quisitos, figura 30.

- a) Que permitiera que las muestras fueran intercambiables fácilmente, para no perder mucho tiempo.
- b) Que permitiera que el electrodo se moviera fácilmente de punto en punto sobre la muestra.
- c) La presión del electrodo de oro sobre la capa de óxido, tuvo que ser el adecuado, figura 31; si fuera excesiva el elec trodo, podría penetrar la capa de óxido y provocar un corto



Figura 29. Diagrama del divisor de voltaje.

R = 140 K ohms, 1/2 R = 70 K ohms.



Figura 30. El dispositivo construído como soporte para las muestras. La muestra (A) descansa sobre la placa de a-- luminio (E), adentro de una pieza de aluminio en forma de "U" (C); dos tornillos (D y D') sujetan la muestra por las caras de sus aristas; el cable de contacto (E). se fija a uno de los tornillos.



Figura 31. El dispositivo construído como soporte para el electrodo de oro. Una barra de plástico (A) está pegada rígidamente a una barra metálica (B) en forma de "S" y a una base cilíndrica de plástico (C); el electrodo (D) es tá sujetado a uno de los tornillos de un contacto (E) de doble tornillo, el otro tornillo sujeta un cable (F) que se extiende a lo largo de la barra de plástico (A) y sa le hacia el equipo de medición.

> Pedazos de metal (G) pegados a la parte superior de la barra de plástico (A), proporciona el contrapeso adecua do para que el electrodo (D) descanse sobre la muestra con la presión requerida.

circuito; si fuera insuficiente, no se lograría contacto electrico estable.

El dispositivo diseñado funcionó adecuadamente en todos los experimentos con excepción de los llevados a cabo en el sis tema de vacío.

Las modificaciones efectuadas en este caso, se describirán posteriormente.

4.5. ARREGLO EXPERIMENTAL, DISEÑADO PARA ESTUDIAR LA REACCION QUIMICA.

El diseño experimental inicial de los traba

63

jos de esta tesis, ya descrito, contemplaba la obtención de características I-V de capas de óxido de alta resistencia, en un rango planteado de aproximadamente - 10 volts a 10 volts.

Pero en el transcurso de esos trabajos se encontró un efecto interesante de switcheo para voltajes menores de - 2 volts o mayores de 3 volts.

El estudio de este efecto, necesitaba cambios en el arreglo experimental.

Se debe notar que en unos casos los arreglos experimentales, que están por describirse, también fueron usados en el rango de - 2 -volts a 3 volts en que no ocurrió el switcheo. El efecto encontrado se muestra en la si-

guiente forma.

Con el arreglo experimental ya descrito, al llegar al voltaje de - 3 volts (fuera del rango - 2 volts a 3 volts), la corriente medida por el electrómetro empezó a aumentar rápidamente, alcanzando en un tiempo de 580 segundos valores del orden de 10^7 más grandes que el valor inicial.

Correspondientemente, apareció una mancha en la superficie de la muestra, claramente visible al levantar el electrodo.

Al aplicar voltajes más negativos de - 3 volts, se encontraron efectos de switcheo en las características.

Se propone en los Capítulos V y VI, que este efecto se debe a una reacción química inducida en el óxido de cromo $\operatorname{Cr}_{9}0_3$, en las condiciones eléctricas del experimento.

$$2/3 \operatorname{Cr}_2_0^3 + 0_2 \rightarrow 4/3 \operatorname{Cr}_3^{(18)}$$

Aumenta la corriente por la mayor conductividad del $Cr0_3$ con respecto al Cr_20_3 .

En experimentos preliminares ⁽⁴⁾ sobre -

las prepiedades eléctricas de estas capas de óxido, llevados a cabo por el Dr. Muhl en la Universidad de Lancaster, se había en-- contrado un efecto que parece ser éste; pero ocurrió en voltajes mayores de 10 volts, tal que la aparición de la reacción a voltajes negativos pequeños (- 3 volts) fue de gran sorpresa.

Una discusión más a fondo de esta reac--ción se presenta en los capítulos siguientes.

A continuación, se describen los arreglos experimentales usados en el experimento sobre las propiedades eléctricas de las capas de óxido en los cuales podría ocurrir reacción.

El circuito básico de medición siguió sien do el mostrado en la figura 27.

jo mucho, haciendo que las dificultades de medición antes menciona das, (ruido, inestabilidad, etc.), ya que no eran tan graves; esto permitió el uso de otros equipos como medidor de voltaje, medi dor de corriente y fuente de voltaje.

Con referencia a la figura 27, los arre--

65

glos pueden dividirse en dos tipos:

A) Arreglo idéntico al usado para -2 V -V 3V, ya descrito.

B) Arreglo en donde:

F = generador de funciones

I = entrada "Y" de un graficador

V = entrada "X" de un graficador

Se describe en turno los detalles de los arreglos.

Con referencia al arreglo A, ya quedo des

crito.

La única adición que se hizo, fue un cronómetro de tipo convencional, para uso experimental sobre el aumento de la corriente con tiempo.

Con respecto al arreglo B, el graficador era de marca Hewlett Packard, Modelo 7045 A, tipo plano. Este graficador responde a voltajes aplicados a sus entradas "X" y "Y", hasta voltajes máximos de 150 volts; tiene un área de 150 in², 15 in para el eje "X" y 10 in para el eje "Y".

Se puede usar para graficar el voltaje "Y" contra el voltaje "X" -(modo X-Y) o el voltaje "Y" contra el tiempo (modo Y-t); para po der medir corriente con este graficador se mide el voltaje através de una resistencia R conocida.

El generador de funciones era marca

66

Hickok, Modelo 5900.

La función que se usó para la mayoría de los experimentos, fue u-
na onda triangular; la frecuencia usada fue de 0.5 Hz.

Con este arreglo, se obtuvieron curvas de característica IV en donde se pudo observar, los efectos de swit -cheo debidos a la reacción.

También se obtuvieron curvas I-t, que sirvieron para seguir el aumento de la reacción.

4.6. SISTEMA DE VACIO.

Puesto que se supuso que la presencia de oxígeno era necesario para que ocurriera la reacción, era de obvio interés repetir unos de los experimentos ya mencionados bajo presiones reducidas de aire.

Para este fin, se construyó un sistema de vacío como se muestra en la figura 32.

En dicha construcción, se utilizó una bomba rotatoria convencional, esta bomba se conectaba a la cámara donde se hacía el vacio. La presión era medida con un manómetro de mercurio, siendo la mínima presión alcanzada de 350 mm. (Hg).

La cámara era una campana de vidrio, que se encontraba sostenida por una placa metálica con salida a la homba, los cables de -



Figura 32. El sistema de vacio construído para estudiar la dependencia de la reacción química de la presencia de oxígeno. Una campana de vidrio (A) descansa sobre una placa metálica (B) 1/2 in de espesor. Un tubo (C) de 1 in de diámetro conceta a una bomba mecánica (D) (rotatoria convencional) a un agujero (E) en la placa metálica (B). En forma semejante otro tubo (F) de 1/4

in de diámetro conecta un manómetro de mercurio (Hg). (en forma de U) con la placa (B). Por otros agujeros (I) en la placa (B) entran en la campana varios cables de conexión (J). El sello entre la campana (A) y la placa (B) es por medio de un anillo "O" de hule y grasa de silicón. Los sellos para los cables de conexión (J) son de epoxy. Los sellos entre los tubos (C) y (F) y la placa (B) son de soldadura. Adentro de la campana se colocaron el soporte para las mues-tras de la figura 30 y el soporte del electrodo de la figura 31; este último fue modificado por reemplazar la barra de plástico por un tubo de vidrio de menor peso de diámetro interior de 3 mm.; un contrapeso de hierro a la altura del electrodo permitía mover éste por medio de un imán desde el exterior de la campana (A). Una reja (K) en forma de campana protege al usuario contra posibles implosiones de la campana de vidrio ಿ≢ (A).

medición entraron por agujeros en la placa; el sello entre la campana y la placa era un anillo "O", los cables se sellaron con epoxy.

Al iniciarse las mediciones eléctricas, se

encontró que la muestra siempre entró en corto circuito: la vibración de la bomba fue transmitida al electrodo de oro que rompió la capa de óxido, así se tuvo que rediseñar el soporte del electrodo, usando vidrio para reducir su peso; el nuevo soporte tenfa en su parte superior un pedazo de hierro para poder desplazar el electrodo por medio de imanes.

Esto se ideó con la finalidad de no quitar el vacío y mover el electrodo de sitio manualmente.

En este sistema de vacío, se obtuvieron gráficas I-t aplicando voltajes en forma de onda triangular y onda senosoidal, tanto en la implantación, como fuera de ella. El vacío máximo a que se trabajó fue de 350 mm. (Hg) y se dismi nuyó de 10 en 10 mm. (Hg) hasta cero (presión atmosférica).

4.7 EFECTO DE LA TEMPERATURA.

Por razones que se describen en el Ca-

pftulo 6, se quiso medir la temperatura en el punto de contacto en tre electrodo y capa de óxido, para ver si subfa mientras ocurría la reacción química. Esto se logró para reemplazar el electrodo de oro por un electrodo que consistía de dos alambres, de oro y aluminio, unidos muy cerca del punto de contacto con la capa de óxido. Este electrodo constituye en efecto un termopar, cuyo voltaje térmico fue medido con un microvoltímetro marca Keithley, Mo delo 155.

El resultado de este experimento fue negativo: no se detectó ningún aumento de temperatura, resultado que se comenta en el Capitulo 6.

'CAPITULO V"

RESULTADOS EXPERIMENTALES

5.1. <u>A RESULTADOS PARA VOLTAJES APLICADOS MENORES DE</u> <u>3 VOLTS QUE NO PRESENTAN REACCION QUIMICA.</u>

En las figuras 33 a 63 se muestran las características I-V obtenidas para varias muestras, tanto fuera como dentro de las regiones implantadas, en temperatura de ambiente. En unos casos los voltajes de medición fueron 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 volts, en otros solamente 0, 1.5 y 3 volts (especificado en cada una de las figuras).

Se notó en el transcurso de los experimen tos que las características encontradas varían según el punto de con tacto del electrodo con la muestra, probablemente por la falta de <u>u</u> niformidad en el espesor de la capa de óxido.

El grado típico de variación se puede estimar en la figura 64 en donde se muestran las características obtenidas para 4 puntos diferentes de la región no implantada de la nuestra V_{12} ; y en la figura 65 se muestran las características obtenidas para la región implantada de la muestra L_5 (implantada con Dy).

> r<u>e</u> 72

Los resultados ya presentados en las figuras 33 a 63



Figura 33. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra F_5 para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (* pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.



Figura 34. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra F₅ para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.



Figura 35. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra $_{F_4}$ para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.









Figura 37. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implautada de la muestra F_4 para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.



Figura 38. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implautada de la muestra r_4 para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.



Figura 39. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra F_4 para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.

COLUMN N



Figura 40. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra F_4 para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.



Figura 41. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra F_4 para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia.



_

_-100

Figura 42. La característica I-V obtenida con el electrómetro en un punto tanto dentro como fuera de la región implantada de la muestra F₄ para voltajes positivos y negativos aplicados de 0 a 5 volts (en pasos de 0.5 volts) y de 0 a -5 volts, en la misma secuencia. Nota: No se debe fijar en los resultados más negativos que -2 volts, en donde se nota la ocurrencia de la reac

ción química.



diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra V_1 para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).



diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra V_2 para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).











Figura 47. La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra V₅ para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).



Figura 48. La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra V_6 para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos

y en otros de .5 volts).



Figura 49.

La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra V_{ij} para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).

0.3

0.2

0.1

s/I 1.5 '3lo Volts

Figura 50. La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la nuesira V_8 para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).









Figura 52.

La característica I-V obtenida con el electrómetro en dicz puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra V_{11} para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).









gura 55. La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la nuestra L_5 para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).



y en otros de .5 volts).



Figura 57. La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tante dentro como fuera de la región implan tada de la muestra L₇ para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).





La característica I-V obtenida con el electrómetro en diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra L_0 para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).

98

,0/I

s/I



diez puntos tanto dentro como fuera de la región implan tada de la muestra L_{15} para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de 1.5 volts para unos casos y en otros de .5 volts).



Figura 60. Las características I-V obtenidas con el electrómetro en diez puntos de cada una de las cuatro áreas dispues tas en la muestra, como se indica en la figura 5. Para la muestra X₆ para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de .5 volts).



61. Las características I-V obtenidas con el electrómetro en diez puntos de cada una de las cuatro áreas dispués
tas en la muestra, como se indica en la figura 5.
Para la muestra X₁₀ para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de .5 volts).



Figura 62.

Las características I-V obtenidas con el electrómetro en diez puntos de cada una de las cuatro áreas dispues tas en la muestra, como se indica en la figura 5, Para la muestra X_{11} para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de .5 volts).


Figura 63. Las características I-V obtenidas con el electrómetro en diez puntos de cada una de las cuatro áreas dispue<u>s</u> tas en la nuestra, como se indica en la figura 5. Para la muestra X_{15} para voltajes positivos aplicados de 0 a 3 volts (en pasos de .5 volts).

3



Figura 64.

Las características I-V obtenidas con el electrómetro en cuatro puntos diferentes de la muestra V_{12} fuera de la región implantada, para voltajes aplicados de 0 a 3 volts en pasos de 0.5 volts.





Figura 65.

presentan los promedios de los datos obtenidos para un mínimo de -10 puntos en cada región.

En general, no se encontró evidencia de --

switcheo, a estos valores tan bajos de voltaje aplicado. En la búsqueda de switcheo y para comprobar su reproducibilidad general de los resultados:

En unas cuantas muestras se repitieron las mediciones en el mismo punto de contacto, subiendo y bajando el voltaje varias veces. Como había de esperarse, (tomando en cuenta la descripción del -Capítulo IV, de los problemas de inestabilidad en el circuito), los resultados no fueron perfectamente reproducibles.

Sin embargo, las características varían poco, la diferencia sien do solamente del 10% entre repeticiones, cifra de reproducibilidad que se considera adecuada.

De vez en cuando una muestra se portó en forma extraña y la co-rriente mientras se bajaba el voltaje fue diferente a esta misma cuando se subía el voltaje.

Pero aparte de esto no se encontraron problemas de switcheo, ni tendencia a desplazamiento permanente con las repeticiones.

En otra prueba más de estabilidad, se de jó una muestra una hora con un voltaje aplicado de 2.5 volts, mo-

nitoreando la corriente y apuntando cualquier variación de la misma. Las variaciones fueron nuevamente del orden del 10% y tampoco se notó ninguna tendencia de desplazamiento permanente de la corriente.

Pertenece a esta parte del capítulo, uno de los muchos resultados obtenidos con el uso de sistema de vacío. En este experimento, se repitió la medición de la característica --I-V de la muestra V_8 , bajo presión reducida de aire; la presión mínima alcanzada fue de 350 mm. de (Hg) no encontrándose ninguna variación de las características ya mencionadas, (este resultado ne_ gativo fue el esperado, puesto que se supone que el número de defectos presentes en la muestra, que afectan su conductancia, está determinado por el tratamiento de calentamiento hasta 750°C que la muestra ha sufrido y no por el equilibrio con la presión parcial de oxígeno en el ambiente en temperatura de 25°C; sin embargo, valió la pena confirmar esta suposición experimentalmente puesto que el experimento era relativamente fácil de hacer).

5.2. RESULFADOS OBTENIDOS EN EXTERIMENTOS CON OCURREN-CIA DE LA REACCIÓN QUIMICA.

Esta reacción se mostró casi inesperada-

mente en el transcurso de extender el rango de voltaje en el experi-

Se mostró en la siguiente forma: al aumentar el valor absoluto de voltaje aplicado en el sentido negativo a un valor típico de 3 volts, la corriente registrada por el electrómetro empezó a aumentarse; con el voltaje mantenido constante, durante varios minutos la corrien te llegó a valores mayores que su valor inicial por muchos órdenes de magnitud; la corriente siguió aumentando hasta llegar a un valor limitado por la resistencia del circuito.

Al levantar el contacto de oro se vió una mancha de color café obs curo, casi negra.

Al seguir aplicando el mismo voltaje en el mismo punto de la mues tra, la muncha creció de tamaño y se notó que estaba en forma líquida.

Al dejar la muestra concetada en esta forma durante un período de varias horas, se apreció entonces un líquido negro en forma de gota alrededor del contacto de oro.

Estos efectos se deben, obviamente, a al-

Puesto que el mismo efecto ocurre igual fuera como dentro de la implantación, se supone que la reacción química involucra al óxido de cromo de la capa $\operatorname{Cr}_2 \theta_3$.

La reacción más probable puede ser una oxidación del $\operatorname{Cr}_2_3^0$ a "Tri óxido de Cromo" Cr $_3$.

 $2/3 \operatorname{Cr}_2^0_3 + O_2 \rightarrow 4/3 \operatorname{Cr}_3^0_3$

por las siguientes razones:

- 1. El color del Cr03 es café rojizo obscuro.
- El Cr0₃ es hidroscópico (forma ácido crómico por reaccionar con el agua).

3. La resistividad del $Cr0_3$ es mucho menor que la resistividad del $Cr_2^0_3$.

Los datos sobre resistividad se obtuvieron en el transcurso del presente trabajo, figura 66.

Se comprimió reactivo analítico de $\text{Cr}0_3$ en forma de polvo en un tubo de vidrio entre dos barras metálicas; se midió la resistividad R con un ohmmétro y por conocer el diámetro D del tubo y la distancia L entre las dos barras se obtuvo la resistividad ρ ----- ρ = R TF D²/4L.

Se repitió el experimento con $\operatorname{Cr}_2 0_3$; se obtuvieron los valores de resistividad de 3 x 10^7 y 1 x 10^6 para $\operatorname{Cr}_2 0_3$ y $\operatorname{Cr} 0_3$ respectiva-mente, (las unidades de resistividad son ohm cm). Los resultados son obviamente imprecisos (puesto que los óxidos de las capas no son polvos comprimidos), pero denuestran que la re-

sistividad de $Cr_2\theta_3$ es mucho mayor que la de $Cr\theta_3$.



Figura 66. Sistema usado para determinar la resistividad de polvos comprimidos de $\operatorname{Cr0}_3$ y $\operatorname{Cr20}_3$. Se comprime el polvo (A) en un tubo de vidrio (B) de diámetro "D" entre dos barras de acero (C,C'); la separación final entre las barras es "L". Se mide la resistividad R en tre las barras por medio de un ohmetro y se obtiene la resistividad por $\rho = \operatorname{RTTD}^2/4\operatorname{L}$.

Por los resultados obtenidos estamos for-

zados a la conclusión que ocurre una reacción química en la muestra y que esta reacción química es inducida en algún sentido por el voltaje aplicado a la muestra en la región donde ocurre la reacción.

En las figuras 33 a 63 se muestran gráficas de la corriente (medida con el electómetro), en el circuito de la figura 27 como función del tiempo, desde el momento de aplicar el voltaje en sentido negativo. A un voltaje de - 2 volt (figura 67) no se nota el aumento de la corriente que es obvio en otras figuras: Pero se nota un aumento de inestabilidad en forma de grandes osci laciones en la corriente que bien pueden indicar los inicios de la reacción.

No se encontró la reacción con voltajes positivos en un rango de voltaje usado hasta 5 volts, figura 67 a 71.

Cada figura de las figuras 67 a 71 presen

ta un experimento hecho en un punto distinto de las muestras V_{11}

y V₁₆.

Obviamente no se pudieron hacer los experimentos en el mismo punto, porque la ocurrencia de la reacción en el punto de contacto causa un cambio permanente en la souestra en este punto. Se consideró importante hacer los experimentos en puntos de apro-



Figura 67. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t des de el momento en que se aplica un voltaje de - 1 volt a un punto de la muestra V_{11} fuera de la región implanta da (se nota el ruido que ocuere).



Figura 68. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t des de el momento de aplicar un voltaje de -2 volts a un punto de la nuestra V₁₁ (se nota que la corriente se es tabilizó por razones todavía no entendidas).
El punto se seleccionó por el método descrito en el tex to (Capítulo V). Jeigura 69. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t deg de el momento de aplicar un voltaje de -3 volts a un punto de la muestra V₁₁. Se nota claramente la ocu rrencia de la reacción química después de varios minu_ tos. El punto se seleccionó por el método descrito en el texto (Capítulo V). Nano-Amprs.

400

300

200

100

300

ö

V11 1-0.42x10⁹Amprs. a +1y 1-27x10⁻⁹Amprs. a -3y

900 t(seg)

Ľ

Figura 70. Desarrolla de la corriente 1 en función del tiempo i des de el momento de aplicar un voltaje de -4 volta a un punto de la uniestra V11; se nota que la reacción guími ca ocurre más rápido que en el caso mostrado en la figura 60; el punto se seleccionó por el método descrito en el texto (Capítulo V).



Figura 71. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo I des de el momento de aplicar un voltaje de -3 volts a un punto de la muestra V_{10} fuera de la región implantada. Se nota la ocurrencia de la reacción química.

Y16

I= 0.22x10⁹ Amprs a+14 I= 2x 10⁹ Amprs a-34

10⁶ Amprs 200 -

100

, Çi

116

300t(scg)

ximadamente el mismo espesor de óxido, (para que el único paráme tro que variara fuera el voltaje) para lograr esto, se anotó al inicio del experimento, el valor de la corriente obtenida a 1 volt en sen tido positivo, situación en que se sabía de antemano que no ocurria reacción .

Para iniciar el segundo experimento, se buscó en la muestra un punto que diera la misma corriente para un voltaje aplicado de 1 velt positivo y así se siguió con otros experimentos.

Se supone que puntos que den el mismo valor de corriente tienen aproximadamente el mismo espesor.

Este procedimiento no es perfecto, pero era el mejor posible en ausencia de equipo sofisticado de medición de espesores, (por reac ción nuclear según se describe en Apéndice B).

En sumario cada figura de las mediciones corresponde a un punto de la muestra de aproximadamente igual espesor.

Por lo tanto, se espera que según aumenta el voltaje V aplicado a la muestra, el campo eléctrico promedio E = V/d (en donde d es el espesor de la muestra) aumento en proporción.

Una dificultad de tipo práctico, con estos experimentos era el desgaste de la muestra ocasionado por la reacción, lo que havía difícil su uso en futuros experimentos.

Por eso, el uúmero de maestras sujetadas a experimentos sobre la

reacción fue limitado.

Para estudios de las características I-V -

de (1 punto de) la muestra en condiciones en que había reacción, = se utilizó el sistema del graficador y generador de funciones des-crito en el Capítulo IV.

La salida de la fuente era una onda triangular, de frecuencia 0.5 -Hz.

La característica I-V obtenidas se muestran en las figuras 10 a 26, cada figura representa un número considerable de ciclos de m<u>e</u> dición; se nota que la característica cambia en cada ciclo, como había de esperarse, porque la cantidad de material reaccionado a<u>u</u> menta constantemente; se aprecian los fenómenos de switcheo que ocurren en ester características, que ahora pueden atribuirse en gran parte a la reacción química; las regiones de las características que muestran resistencia negativa son grandes.

Se nota que, aunque cada característica es cuantitativamente distinta, existen semejanzas importantes entre las características; presentan picos a voltajes denominados V_1 , V_3 , V_5 y V_7 y valles V_2 V_4 y V_6 que son sorprendentemente reproducibles de ciclo a cíclo en cada figura.

Los veltajes de los picos V_1 , V_3 , V_5 y V_7 son aproximadamente iguales aún en diferentes figuras que corresponden a diferentes pun tos de la misma muestra y(difícil de creer) en diferentes figuras que corresponden a diferentes muestras.

Estos voltajes deben tener algún significado profundo en el fenómeno de la reacción.

Aún se presentó otro fenómeno interesante en estos experimentos; una especie de memoria.

Esto se notó cuando se dejó de aplicar el voltaje a la muestra en un punto determinado de la característica, como es el caso del pico descrito anteriormente como V_{α} .

El graficador se dejó funcionando durante unos segundos y cuando el brazo del graficador pasó por el punto donde se le había suspen dido la aplicación del voltaje, este se aplicó nuevamente, observándose que se continuaba la reacción justamente donde se había pa rado.

Con el objeto de verificar si sufría alguna modificación con el tiem po, se interrumpió el voltaje en la muestra durante un tiempo de -10 minutos; luego de este tiempo se aplicó nuevamente el voltaje y volvió a seguir el mismo curso normal; se deduce que el producto de la reacción se quede en algén estado de transcición estable en = ausencia de voltaje aplicado.

Para confirmar que en estos experimentos

era adecuada la resistencia interna de la entrada "X" del graficador que funciona como un voltimetro, se eliminó del circuito esta entra da; y se encontró que la corriente seguía variando con la misma amplitud.

También se usó el graficador en la forma Y-t para obtener gráficas de corriente contra tiempo, en las mismas condiciones en que se obtuvieron las características, estas -gráficas se muestran en las figuras 72 a 77.

Finalmente se usó el graficador para obte

ner gráficas de corriente contra tiempo para varias muestras mantenidas a presión reducida en el sistema de vecío de las figuras 78 a 88; estas gráficas se obtuvieron en algunos casos con ondas seno soidales y en ctros con ondas triangulares, se muestran en las figu ras 78 a 88 que se llega a conclusiones importantes, de que la reac ció no ocurre si la presión del aire está suficientemente reducida; esto es otra indicación de que la reacción que ocurre es una oxida ción; y comprueba que el oxígeno viene del medio ambiente y no del oxígeno presente en la muestra.

En las figuras 78 a 88 se notará también

una diferencia posiblemente significativa entre las gráficas obtenidas

FIGURA 72

Figura 73. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo 6 deg de el momento de aplicar a un punto de la musetre V fuera de la implantación un voltaje en forma de sedal triangular de 0.5 Hs y amplitud pico a pice de 1 vali ; por pulgada. La escala para tiempe fue de 56 eng/m la escala para corriente tuvo que ser cambinde en 160 puntos A. B. C y D del eje t y as en A 1 X 10⁻⁶ ampere/in; en B es de 5 X 10⁻⁶ ampere/in; es C es 1 Z 10⁻⁶ ampere/in; en D es de 5 X 10⁻⁶ ampere/in;

E



FIGURA 73

Desarrollo de la corriente I en función del tiempo de el momento de splicar a un punte fuera de la implantación un voltaje en forma triangular de 0.5 Hs y amplitud pice a pice por pulgada; escala para tiempo; 50 seg/is, 1a para corriente tuvo que ser cambiada D del eje t y est en A 1 X 10 B 5 X 10" ampers/in. en C 1 X 10" am D 5 X 10" ampers/in.

8

Y.M.



11

AB

A CLASSICAL

Va

R=1K

12

Figura 74. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo i des de el momento de aplicar a un punto de la muestre Va fuera de la implantación un voltaje en forma de sellal triangular de 0.5 Hs y amplitud pico a pico de 5 velts por pulgada; escala para tiempo: 50 seg/in, la escala para corriente tuvo que ser cambiada en los piece A. E. C, D y E del eje t y es: en A 5 X 10" ampers/m, en B 1 X 10" ampers/in. en C I X 10" ammers/is y en D 1 X 10" ampera/in; en E 5 X10" ampera/in-

with the state of the state of

population southers



Figura 75. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t deg de el momento de aplicar a un punto de la inuestra V₃ dentro de la implantación un voltaje en forma de señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 2 volta por pulgada: escala para tiempo 50 seg/in, escala para corriente se cambia en los puntos A y B del: eje t y es en A 1 X 10⁻⁴ ampere/in y en B 5 X 10⁻⁴ ampere/in.

adam filt of and fings to mer Producertate

hinak

Figura 76. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t desde el momento de aplicar a un punto de la muestra V₃ fuera de la implantación un voltaje en forma de una señal triangular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 6 volts por pulgada. Escala para tiempo 50 seg/in, escala para corriente de 1 X 10⁻⁵ ampers/in. its and

n función del tiempo t un punto de la muestra voltaje en forma de una unplitud pico a pico de 6 ura tiempo 50 seg/in, es-5 ampers/in.

FIGURA 76

V₃









Figura 77. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t deg de el momento de aplicar a un punto de la muestra V₃ fuera de la implantación un voltaje en forma de una senal triungular de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 2 volts. Escala para tiempo 50 seg/in: escala para corriente 1 X 10⁻⁵ ampers/in.

al dadianti

10 MV/IN 870mm 3(0 380mm Hg 430mm Ha 250mm Pla بالسالب الس 43000 50MV/IN n na sa Ratis - **460**mm $-\Lambda_{-}\Lambda_{-}$ AAAA 470mm Hg <u>_N</u> -M-M-M 480mm Hig 520mm Hg 540mm Hg

0mm Hq 480mm Hg **50MV** 450mm 2 Hg Eldhandall 470500 I A A A A MAAAA A 4 Clambo Li - A- A- A- \mathcal{A} A A AL a 1 . Juli Autor Auto Ĵ, " SV.0...., 540mm Hg 1-11 545mm Ho 550**m**m He 560mm Hg 580mm Hg Figura 80. Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t des de el momento de aplicar a un punto de la muestra V_5 fuera de la implantación un voltaje en forma senosoidal de 0.5 llz y amplitud pico a pico de 5 volts, para dife-

usuganit amplot a solution un voltate en torma triangular. de el momento de aplicar a un punto de la muestra V5 Deantrollo de la corriente I en functón del tiempo t deg .87 sauget бн 6н шш029 6H 950mm 64 440999 Sid Line Dos 54 40000 0-1 444.057 64) ШШ0577 H бн Luoy, H 100,069 514 MMOLE H 320WW 6H WWOES ςV 82740ରାସ NITTO 7/S






dentro de la región implantada y las obtenidas fuera de esta región, con respecto a los picos denominados "A" en las figuras 78 a 88; estos picos son más comunes en la región implantada.



















 $[- \frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$ $[-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]_{570mm}]$ $= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_$

50MV/IN MARAMAN AND $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j$ $\left| \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \begin{array}{c} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \begin{array}{c} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \begin{array}{c} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \begin{array}{c} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \begin{array}{c} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\ \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \end{array}{} \\$ \\ -05V/IN

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$ 560mm | 19 570mm H









Desarrollo de la corriente I en función del tiempo t des de el momento de aplicar a un punto de la muestra Va fuera de la implantación un voltaje en forma senosoidal de 0.5 Hz y amplitud pico a pico de 5 volts, para dife rentes presiones de aire en el sistema de vacío; para

las curvas correspondientos la presión (indicada en milímetros de mercurio) se muestra en la gráfica.

Figura 88. Se obtiene de la figura 81 por graficar la corriente má xima (altura de pico en cada gráfica de la figura 81) contra la presión de aire correspondiente.

510 530 550 590 mm Hg

ALTU-RA

15 -

10

5

450

470

"CAPITULO VI"

DISCUSION Y CONCLUSIONES

6.1. EN AUSENCIA DE LA REACCION QUIMICA.

Las características I-V obtenidas para las capas de óxido en el rango de voltaje de hasta + 3 volts de las figu ras 33 a 63 no son lineales y muestran asimetría entre voltajes positivos y negativos en los primeros casos.

Esto implica que el óxido no se comporta como una simple resisten cia sino que existen regiones de carga espacial en el óxido; tales re regiones podrfan ser, (a) uniones p-n en el óxido, (b) regiones de car ga espacial cerca de los contactos metálicos; en todo caso, las regiones de carga espacial se deben a defectos o impurezas cargadas en el óxido.

Puesto que las características parecen ser estables con respecto al tiempo, se deduce que el perfil de concentración de los defectos e impurezas no cambia bajo la acción del campo eléctrico aplicado al óxido; esto implica que los defectos o impurezas son inmóviles, o que los contactos no bloquean un movimiento.

Si éstes fueran méviles y si los contectos bloqueeran su movimiento, con la aplicación del voltaje los defectos o impurezas se amontonarían corea de los contactos, cambiando las características I-V. Las características muestran que la resis-

tividad del óxido de cromo (Cr_20_3) es bastante alta; obviamente no se puede deducir rigurosamente un valor para la resistividad, por las siguientes razones;

a) Las características no son lineales.

- b) La resistividad del óxido probablemente no es uniforme en la capa, sino que varía de punto en punto, según el perfil de la concentración de defectos e impurezas.
- c) No se conoce, en términos absolutos, el espesor de la capa de óxido.
- d) No se conoce el área de contacto entre el electrodo de oro y el óxido; (este podría ser menor que el área aparente del con tacto, debido a que la superficie del óxido es rugoza y quizá

faltan contactos físicos entre el oro y los valles del óxido). Sin embargo, es posible estimar el orden de la magnitud de la resistencia del óxido, en la siguiente forma:

- 1) Se define una resistencia R como R = V/I en donde V es igual a 1 volt e I es la corriente correspondiente.
- Se toma el valor de 5,000 Å como típico del espesor d de la capa de óxido.
- 3) Se estima que el área de contacto es 10^{-6} cm²⁽²⁾) (nótese que ésta es el área de contacto con el electrodo de oro; puesto que el ancho del área de contacto es mucho más gran

de que el espesor del óxido, el flujo de corriente será perpendicularmente directo desde el oro hasta el cromo y así el área de contacto entre el óxido y el cromo no entra en el cálculo), véase figura 89.

4)

En base a la figura 50, ahora se puede calcular un valor de "resistividad" $\rho = RA/d$ del óxido de cromo en X 10⁷ ohms cm.; este valor se debe comparar con el valor (3 X -10⁷ ohms cm.) de la resistividad del polvo comprimido de - $Cr_2^0_3$, medido por el método descrito en el Capítulo V; en todo caso se nota que el valor de la resistividad del $Cr_2^0_3$ es grande.

Ahora se pueden comparar las caracterís ticas obtenidas (en cada muestra) en las regiones implantadas con las obtenidas fuera de la misma.

Se nota primer, que la corriente es siempre más grande en la región implantada que en la región no implantada (para un voltaje dado), pero este resultado significa poco puesto que el espesor del óxido es siempre menor en la región implantada (es decir, r < 1). Una comparación más significativa es en base a la resistividad del óxido en las dos regiones.

Sean d_i , d_s los esposores del óxido en la región implantada y la región no implantada, respectivamente, sean I_i , I_s las corrientes reg



Figura 89. El dibujo es esquemático, pero aproximadamente a escala de los tamaños relativos del electrodo de oro y <u>ó</u> xido. Se nota que en esta situación el flujo de co-rriente ocurrirá únicamente en la región abajo del elec trodo y será despreciable en las otras regiones. pectivas para un voltaje aplicado de 1 volt, sean ρ_i , ρ_s las "resistividades" respectivas definidas en la forma mencionada y sean - A_i , A_s las áreas de contacto respectivas.

$$\rho_{s} = (1/I_{s}) (A_{s}/d_{s})$$

$$\rho_{i} = (1/I_{i}) (A_{i}/d_{i})$$

y por lo tanto.

$$\rho_{\rm s}/\rho_{\rm i} = ({\rm I}_{\rm i}/{\rm I}_{\rm s}) \ ({\rm d}_{\rm i}/{\rm d}_{\rm s}) \ ({\rm A}_{\rm s}/{\rm A}_{\rm i})$$

Ahora se supone que (a) los puntos elegidos son "típicos", en el sen tido que se puede reemplazar d_i/d_s por r, el "oxide ratio" de la muestra medida en trabajos anteriores por la técnica de reacción nuclear inducida (b) las árcas de contacto son comparables en los dos casos, para que se pueda reemplazar A_s/A_i por 1; con esto -

$$P_{\rm s}/P_{\rm i} = r (I_{\rm i} / I_{\rm s})$$

lo que permite la comparación de las resistividades.

En la tabla 3 se muestran los valores así calculados para ρ_s / ρ_1 para diferentes muestras; éste es iguel a la proporción σ_i / σ_s entre las conductividades, puesto que $\sigma_s = 1 / \rho_s$, $\sigma_i = 1 / \rho_i$. Se neta que σ_i es siempre mayor que σ_s , este resultado es razonable, puesto que el proceso de implantación provoca daños en el éxido aumentando el número de defectos; implica, (a) un aumento del número de defectos cargados, como vacancias que podrán contribuir a la conducción iónica en el óxido; (b) un aumento correspondiente en el número de portadores electrónicos que contribuyen a la conducción electrónica en el óxido, (en cambio, es difícil entender por qué el óxido crece menos en la región implantada (r < 1), si la conductividad iónica fuera más grande en esta región).

Siguiendo la misma línea de pensar, se

quiso comparar la conductividad O_1 de cada región implantada con el espesor d_i del óxido en la misma región, en búsqueda de correla ción entre la conductividad del óxido y facilidad de oxidación del m<u>e</u> tal.

Otra vez ésto no fue posible en forma absoluta, por falta de conoci miento de d_i, pero si se supone que d_s es igual para todas las -muestres, en base a que fueron oxidadas, todas en la misma atmós fera, a la misma temperatura y durante el mismo tiempo y que - $\sigma_{\rm S}$ es igual para todas las muestras, entonces d_i sería proporcional simplemente a r y $\sigma_{\rm i}$, sería proporcional a la cantidad --

 O_i / O_s ya tabulada.

Por lo tanto, se puede mostrar la dependencia de σ_{i} en d_{i} por gratificar (σ_{i}/σ_{s}) de la tabla 3 contra r, para el conjunto de -

nmostras; esta grática se muestra en la figura 90. Se ve que el grado de correlación no es alto; pero que parcee ha-



ber cierta correlación en el sentido de que las 6 muestras que se oxidaron muy poco (r < 0.25) también tienen poca conductividad del óxido. Muestras que se oxidaron mucho pueden tener alta o baja conductividad; se nota que el cromo en la región no implantada es un ejemplo de este último tipo de muestra, en que se oxida mucho pero tiene baja conductividad.

Sería difícil hacer más interpretaciones de estos datos sin conocer las respectivas contribuciones iónica y electrónica a la conductividad, las cuales no se obtuvieron en el presente trabajo.

En las figuras 91 a 103 se muestran gráficas de σ_i / σ_s contra varios parámetros característicos de los elementos implantados (los mismos parámetros que aparecen en los trabajos antecedentes (3) mencionados en el Capítulo III).

Se ve que no existe correlación entre la conductividad del óxido y <u>o</u> tros parámetros como son: electronegatividad, radio iónico, valencia, calor de formación de óxido, potencial de oxidación y peso atómico, como se muestran en las figuras 91 a 103 (distinguiendo en tre muestras que sufrieron annealing y otras sin dicho tratamiento).

6.2. LA REACCION QUEMICA

La hipótesis de la presente tesis, acerca

146

de la reacción guímica, está descrito en el Capítulo V.

Ahora se pueden hacer varios comentarios sobre los resultados obte-



••••

2

6

VALENCIA

1/05

1212 4

Figura 92. Gráfica de Ci/ Ca contra radio idaiso de sus que no sufrieron el tratamiento de ameeitar ida

due no surrirron a transmission of a

plantado).

8

6

4

2

-1

Figura 93. Gráfica de "i/ "s contra electronegatividad que no su frieron el tratamiento de annealing (datos obtenidos da las tablas 2 y 3 con referencia al material implemento),

20

ELECTRONETIVIOND

149

1.0

8

5



1.1.1.1

10

8

6

2

1/05

Figura 95. Gráfica de ^Gi/ Ge contra potencial de oxidazion en muestras que no sufrieron el tratamiento de expres (datos obtenidos de las tablas 2 y 3 convreterados material implantado).

20

.... of other last in the state

POTECIAL DE







VALENCA

ofs


Figura 100. Gráfica de σ i/ σ s contra electronegatividad del material implantado, para muestras que sufrisron el trata-

miento de annealing (datos obtenidos de las tablas 2 y

ELECTRONEGATIVELD

ΕY

3).

5.6

24

18

:2

Figura 101. Gráfica de σ i/ σ s contra calor de formación del óxido del material implantado, para muestras que sufrieron el tratamiento de annealing (datos obtenidos de las tablas 2 y 3).

-400

CALOR DE EORMACIÓN

5, 173

24

13

12

6

14 27 4

Figura 102. Gráfica de 51/ 55 contra potencial de oxidación del material implantado, para muestras que sufrieron el tratamiento de annealing (datos obtenidos de las tablas

3

POTENCIAL DE OXIDACIÓN

2 y 3).

.

2

~;/~s

24

18

Figura 103. Gráfica de σ i/ σ s contra peso atómico del material implantado, para muestras que sufrieron ol tratamiento de annealing (datos obtenidos de las tablas 2 y 3).

200

1. 1. 1. 1.

100

16

12

6

PESO ATOMICO 159 nidos en los experimentos en que ocurrió reacción química; se ve en las figuras 72 a 78 que el efecto de la reacción química sobre las propiedades eléctricas de las muestras es complejo y no se pres tó a fácil interpretación.

Esto es de esperarse, dadas las complicaciones de la situación física; en presencia de la reacción, los caminos por los cuales fluye la corriente seu caminos determinados por la presencia de CrO_3 en la capa, caminos que no son constantes en el tiempo; y todo se complica más por la naturaleza hidroscópica del CrO_3 que introduce líquido en la muestra.

Esta es totalmente diferente a la situación relativamente homogénea que existe en ausencia de la reacción.

Si la reacción ocurriera solamente en la superficie de Cr₂O₃, cerca del electrodo de oro, sería poco prob<u>a</u> ble que afectara en forma tan drástica las propiedades eléctricas de la muestra.

Mucho más probable es que la reacción se extiende dentro de la capa y que el aumento rápido en corriente mostrado en las figuras 10 a 26, corresponde a que la reacción se extiende dentro de la capa; es docir, que ya existe un filemento de CrO_3 de relativamente alta conductividad que une el electrodo de oro con el cromo metálico.

La idea normal encontrada en la literatu

ra es que el cromo se mueve por difusión de iones de cromo hacia el exterior y no por la difusión de iones de oxígeno hacia el interior. En los trabajos antecedentes descritos, se encontraron indicaciones que ésto no es cierto, sino que la difusión de iones de oxígeno sí ocurre durante la corrosión de cromo.

Ahora los resultados obtenidos en la presente tesis se pueden interpretar como una indicación más de que la difusión de oxígeno en el cromo ocurre más fácilmente de lo que se crefa; queda establecido por los experimentos efectuados con el sistema de vacío, que la reacción necesita la presencia de oxígeno en el ambiente y por el argumento del párrafo anterior, este oxígeno entre la muestra y pa rece llegar hasta el otro lado de la misma sin mucha dificultad.

Surge la pregunta obvia; ¿Por qué ocurre

168

la reacción ?. Una posibilidad que se debió investigar, era la siguiente: al pasar corriente por Cr_2O_3 éste se calentaría por efecto Joule, llegan lo finalmente (si la corriente era suficientemente grande) a temperatura tal que reaccionaría con el oxígeno del aire. Aunque las corrientes medidas eran muy pequeñas, también era pequeán la región por la cual fluían; est la disipación de calor por unidad de volúmen podría ser apreciable. Esta posibilidad ahora se puede descartar, por el resultado negativo del experimento en que el electredo de oro se reemplazó por un ter mopar cuya unión hizo contacto con la muestra.

Un aumente de la temperatura de unos 50°C habría producido un vol taje térmico del orden de un milivolt; pero el resultado del experimento fue que el voltaje "térmico" registrado fue del orden de mi crovolts; es decir efectivamente cero, aún en presencia de corrien tes grandes que fluyeron <u>después</u> de que ocurrió la reacción.

Parece cierto entonces, que la reacción es inducida directamente por un campo eléctrico o voltaje aplicado a la capa de óxido.

Una posibilidad sería que la reacción se originara al llegar el campo eléctrico adentro de la capa a tal valor que provocara movimientos de iones de oxígeno presentes en la capa.

Pero esta posibilidad también se debe descartar, después de considerar los resultados experimentales.

Estos muestran que la ocurrencia o no de la reacción es cuestión del voltaje aplicado a la muestra, no del campo eléctrico.

Se nota por ejemplo, que en las muestras V_{11} y V_{16} la reacción ocu rre en voltajes comparables; en estos voltajes los campos eléctricos serien muy diferente, porque el espesor del óxido es muy diferente en las dos muestras.

Este resultado es general: el voltaje parece ser la variable significa tiva, independiente del espesor de la capa de óxido.

Esto se nota también en las figuras 10 a 26; se comentó en el Capí tulo V que los voltajes V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , V_5 , V_6 y V_7 de los picos y valles son casi iguales para todas las muestras, que por cierto no tienen espesores de óxido iguales.

Una reacción inducida más bien por voltaje que por campo cléctrico, podría ser del tipo electroquímico; en este caso sería cuestión de una celda electroquímica con una electrolita sólida.

Alternativamente, la reacción podría estar limitada por alguna barre ra de potencial eléctrico en la <u>superficie</u> del óxido; el voltaje reque rido para iniciar la reacción sería el voltaje que reduzca la altura de la barrera a cierto valor.

En los resultados obtenidos en este trabajo no existen bases para distinguir entre estas dos posibilidades.

Se nota que la reacción ocurre solamente si el electrodo de oro tiene un voltaje de signo negativo; este es elsigno requerido para mover los iones de oxígeno hacia el interior de la capa desde el electrodo de oro o desde la interfase aire-óxido. En cambio un voltaje por itivo tenderá a extraer iones de oxígeno desde el interior de la capa hacia el electrodo de oro.

Con voltajes positivos no se encontró indicación de la reacción química. (Al aumentar el voltaje en sentido positivo hasta un valor típicamente – de 10 volta, ocurrió otro tipo de ruptura cléctrica: la muestra se puso de repente en corto circuito y no apareció ni mancha ni líquido, típicos de la reacción considerada; la ruptura que ocurrió es típica de la condu<u>c</u> ta de un dieléctrico en alto campo eléctrico).

La mera ocurrencia de la reacción química -

no es suficiente para explicar la ocurrencia de los fenómenos de -- switcheo mostrados en las figuras 10 a 26 . Es necesario considerar a qué se deben las regiones de las características con resistencia negativa. (Es decir, las regiones en que al aumentar el voltaje disminuye la corriente). La única idea que se tiene, (imprecisa), es la siguiente: después de iniciarse la reacción, la conducción es por filamentos algo inestables de CrO_3 , que se extienden entre el oro y el cromo; al llegar a cierto valor de voltaje, unos de estos fi lamentos se rompon, quizá por sobrecalentarse, así reduciendo la corriente; al llegar a un voltaje aún mayor, se forman filamentos otra vez porque mayor voltaje favorece la reacción y porque quizá la capa ya se enfrió en las condiciones de reducida corriente. Alllegar a un mayor, voltaje los filamentos se rompon etra vez y asícontinuamento.

Pero le idea no coincide bien con los hechos de que no se delectó ningún aumento de temperatura durante la reacción y que los voltajes

de los picos y valles de las características son reproducibles. Así, los fenómenos de switcheo observados se quedan sin explicación. Una teoría completa deberá centrarse en el significado obviamente importante de estos voltajes.

6,3 SUMARIO DE LAS CONCLUSIONES.

- El comportamiento eléctrico de las capas de óxido no muestra efectos de switcheo para voltajes aplicados entre -2V y +3V -. (con la convención de signo establecido en el Capítulo IV).
 Las características I-V (figuras 33 a 65) no son lineales, y muestran asimetría entre voltajes positivos y negativos, indicando la presencia de carga espacial en las capas de óxido.
 En cambio, las características parecen ser estables, indicando que el perfil de concentración de carga espacial es constan te en el tiempo.
 - 4. La conductividad del óxido (en el sentido defínido en este Capítulo), es mayor en la región implantada que en la región no implantada.
 - 5. Le conductividad del óxido es pequeña en regiones implantadas que se orideron poco (r < 0.25).

En regiones que se oxidaron más, la conductividad del óxido puede ser mayor per un factor del orden de 10; pero también paede ser igualmente pequeña. (De ésto se deduce que la con-

ductividad es probablemente una variable importante en una teoría correcta de corrosión, pero que no es la única variable importante).

 Al aplicar un voltaje mayor de 3 volts en sentido negativo a las capas de óxido, ocurre una reacción química que parece ser una oxidación de Cr₂O₃ a CrO₃. La reacción se muestra inicialmente por aumento rápido de corriente. La reacción no ocurre para voltajes aplicados en el sentido po-

sitivo.

- La reacción ocurre cuando el voltaje aplicado llega a determina do valor, independiente del valor del campo eléctrico.
- La reacción no ocurre si se reduce suficientemente la presión de aire (Ver figuras 73 a 88).
- Se deduce que iones de oxígeno pueden entrar y difundirse en 6xido de cromo, con mayor facilidad que la que sugiere la literatura.
- Las características de las capas de óxido en condiciones en que ocurre la reacción química, muestran efectos de switcheo, toda vía no entendidos.

"CAPITULO VII"

FUTUROS TRABAJOS

La presente tesis ha mostrado un bosque jo inicial de las propiedades eléctricas de las muestras estudiadas. Para llegar a un entendimiento completo de estas muestras a nivel microscópico, se requiere de varios años de investigación en forma sistemática y se requerirá del uso de equipos todavía no disponibles on la ENEP.C.

Ahora se sugieren trabajos que representarían la continuación de los trabajos efectuados.

Un mejoramiento obvio de los resultados de los presentes trabajos, podría obtenerse con el uso de equipo para la medición de espesor de capas.

Los resultados actuales, están limitados por conocerse únicamente, el "oxide ratio" de cada muestra, que es una medida relativa de espesor y promediado sobre la muestra.

Se l'ebe conocer el espesor en términos absolutos y en el punto de contacto eléctrico con la muestra.

Existe equipo para la medición de espesores de capas en el Instituto de Físico de la UNAM (que funciona a base de retrodispersión de Rutherford de un leze de protones o particulas alfa). Sería de gran importancia obtener las ca-

racterísticas I-V como función de la temperatura en la muestra en tre - 100 y 800°C.

Al aumentarse la temperatura, los procesos de conducción en un óxido ocurren con más facilidad.

Se podría esperar que la corriente en un voltaje dado sería proporcional a un factor de tipo $\exp(-E_a/kT)$ donde k es la constante de Boltzmann, 'T es la temperatura en grados absolutos y E_a es la energía de activación del proceso, por ejemplo: en el caso de la conducción electrónica, E_a sería la energía de la banda prohibida del óxido; en el caso de la conducción iónica, E_a sería la energía de activación para el movimiento de un ión. Por graficar el logaritmo de la corriente contra 1/T, uno podría -

obtener E_a , de la pendiente de la línca recta que debe resultar, así obteniendo la información sobre los procesos de conducción a ni vel microscópico.

Este experimento clásico de la física del

estado sólido no ha sido posible en general en los presentes trahajos (a) por falta de equipo para enfriar la nuestra y (b) por pro-blemas de oxideción al calentar las nuestras (para poder calentar las nuestras sin causar que se oxide más, se requiere de un sistema de más alto vacío que el que se construyó en el caso del pre sente trabajo).

Se atrevió a calentarse sólo una muestra que tenía un espesor gran de de óxido, en todo caso, los resultados se muestran en las figuras 104 a 107.

Se nota que a causa del gran espesor de óxido, las corrientes son más pequetas que las normales y por lo tanto menos estables y m<u>e</u> nos confiables; además el rango de temperatura no es amplio. Correspondientemente, las gráficas de logaritmo de la corriente – contra 1/T (se muestran en las figuras 104 a 107), muestran grandes errores si se intentan interpretar como líneas rectas. Sin embargo, si se dibuja la mejor línea recta, se llega a valores de la energía de activación de~leV, que son razonables. Así se ha establecido en el presente trabajo, que futuros trabajos de este tipo, serían de provecho, una vez conseguido el equipo ad<u>e</u> cuado.

Otro experimento clásico sería investigar

las corrientes que fluyen en las capas bajo aplicación de pulsos de voltaje preferiblemente de unos nano seguelos de duración y se parados uno del otro por tiempos del orden de milisegundos. Así puede uno aplicar mayor voltaje a la muestra sin riesgo de producie matura eléctrica, por calentaria, puesto que las corrientes flayen en tiempos muy cortos.



50 Figura 101. Características L-V obtenidas con electrómetro en un punto de la muestra V16 para diferentes temperaturas 335°K, -T de la muestra: (a) T = 316°K, (b) T " 390°K, -373°K, (0) T * (c) T * 353°K, (d) T = 444°K y 427"K, (h) T 408°K, (g) T * (f) T = 463*K. (i) T •

Figura 105. Gráfica del logaritmo de la corriente contra 1/T para voltaje de -1 volt aplicado a la muestra V₁₆ (datos obtenidos de la figura 104). De la pendiente de la Knea recta dibujada se obtiene un valor de la energía de activación E_a de 1,10 eV.

V₁₆

V=-1

-23

Figura 106. Gráfica del logaritmo de la corriente contra 1/T para voltaje de +1 volt aplicado a la muestra V_{16} (datos obtenidos de la figura 104). De la pendiente de la <u>1</u> nea recta dibujada se obtiene un valor de la energía de activación E_a de 0,21 eV.

1:1.**

V16

is there have a

V=+1V

Figura 107. Gráfica del logaritmo de la corriente contra 1/T para voltaje de +2 V aplicado a la muestra V₁₆ (datos obte_ nidos de la figura 104). Se nota que los puntos no siempre caen en una línea recta.

412

Vis

a string a hi

C IL CARACT

V= +24.

-25.5-

-25

-24

-23

(*). **

También se espera poder separar las dos contribuciones, electróni ca e iónica, a la conducción, puesto que los iones son mucho más pesados que los electrones y no tendrían tiempo de moverse si la duración del pulso fuera may pequeña.

Obviamente, para poder llevar a cabo estos experimentos, se re-quiere de un generador de pulsos de adecuada precisión. La detección de las corrientes y voltajes sería por medio de un o<u>s</u> ciloscopio ya disponible.

Es quizá sorprendente que las características I-V encontradas en este trabajo eran tan estables en situacio nes de conducción iónica.

No es raro encontrar que las propiedades eléctricas cambien lenta mente con el tiempo, debido a un movimiento de iones que cambie el perfil de concentración de carga en la muestra.

La "estabilidad" encontrada en el presente trabajo, se refiere a -tiempo de unas horas de someter a la muestra a un voltaje cons-tante de 2.5 volts.

Sería interesante dejar conectada una muestra (por ejemplo a una pila) durante el período de unos meses, monitoreando las corrientes en búsqueda de cambios más lentos en sus propiedades eléctricas.

141

Se encontró al iniciarse el trabajo que los resultados varían según el metal usado como electrodo de contacto con la capa de óxido.

El procedimiento seguido fue el de usar oro, por su mayor estabilidad química.

Pero se pueden llevar a cabo experimentos con otros electrodos e intentar explicar porqué los resultados varían de un metal a otro. Sería necesario acceso a equipos sofisticados de análisis que pudieran detectar pequeñas cantidades de metal de electrodo que se haya difundido hacia dentro de la muestra.

Quedó mucho que hacer en investigar la reacción química encontrada en el presente trabajo.

Un problema general con este tipo de investigación, es que cualquier resultado eléctrico depende de toda la historia previa de la muestra, puesto que cada aplicación de voltaje, crea una cantidad más de - -Cr0₃ en la muestra, lo que complica el diseño de cualquier experimento.

Si se intorpreta la reacción química como un fenómeno electroquími co o no será necesario tener algún sistema para medir la cantidad de material reaccionado, preferiblemente en forma no destructiva de la muestra. En términos de experimentos puramente

eléctricos, los parámetros más significativos encontrados hasta ahora, parecen ser los voltajes de los picos y de los valles de las figuras 10 a 26 y los voltajes mínimos en que se inicia la reacción. Sería interesante investigar si estos voltajes varían en forma siste mático como función de otros variables como es la temperatura.

Otro camino complementario para estudiar los efectos de la reacción química, sería estudiar las propiedades eléctricas de capas de $Cr0_g$ hechas a partir de reactivo analítico de $Cr0_g$.

Esto se podría hacer por disolver Cr03 y posteriormente pintar un portaobjetos con la solución y evaporar el solvente.

Trabajos a más largo plazo, obviamente incluirán estudios sobre muestras preparadas, a base de otros metales que el cromo.

"APENDICE A"

IMPLANTACION IONICA.

- Se describe esta técnica en forma general, con referencia a la figura 108.
- a) Se producen iones del clemento que se quiere implantar en la fuente de iones (1). Esta fuente funciona en base a un plas ma en forma complicada.
 - b) Abajo de la fuente de iones (1), se extiende una columna (2) de unos 3 m. cuya parte superior se mantiene en un potencial eléctrico positivo de 250,000 V con respecto a la parte interior. Este potencial eléctrico es producido por un generador de voltaje conocido como "doblador de voltaje", que es capaz de producir hasta 3,000,000 de volts.

Como resultado, los iones positivos producidos en la fuente se acelera hacia abajo, saliendo de la columna con energías del orden de 250,000 (q/e) electron-volts, en donde q es la carga del ión y e es la carga electrónica.

Un electroimán (3) produce un alto campo magnético que des vía el haz de iones por un ángulo de 90° para que el haz salga en dirección herizontal.

177

c)



Puesto que la desviación angular de un ión al atravesar el campo magnético depende de la energía del ión y del valor del campo magnético y puesto que el orificio (4) por el cusl sale el haz es pequeño, el imán (3) sirve como filtro permitiendo salir por el orificio (4) únicamente iones con la energía descada; se puede ajustar este valor de energía por ajus tar la intensidad del campo magnético (por ajustar la corrien te que flaye en sus bobinas).

Finalmente el haz de iones entra en la cámara (5) en donde está dispuesta la muestra que recibirá la implantación. Obviamente es necesario que el haz de iones esté bien anfocado y controlado durante su viaje desde la fuente de iones -(1) hasta la cámara (5); (a) el proceso de enfocar se logra por una lente Einzel (6) y otra lente (7), de función mognéti ca cuadripolar; (b) el control de la posición del haz se logra por dos conjuntes (6) y (9) de placas de deflezión X-Y electrostáticas, (semejantes a las placas usadas en tubes de rayos catódicos).

d)

2.

Las placas (0) y (9) constituyen un sistema de barrido, como en un televisor; así el área de la muestra sujeta a la implantación puedo ser mucho más grande que el tamaño del haz de icces.

También es obvio el hecho de que todos los procesos tienen que ocurrir en alto vacío.

El vacío es producido en su mayoría por una enorme bomba (10) de difusión de aceite (de 20,000 litros/seg.) respaldada por una bomba mecánica rotatoria (11); cerca de la cámara trabaja una bomba turbomolecular (12) y una bomba iónica (13). Una trampa de nitrógeno líquido (14) capta átomos de impurezas como hidrocarburos (que vienen del aceite de la bomba de difusión).

El grado de vacío alcanzado es de 10⁻⁷ Torr (un Porr El 1 mm. Hg).

La cámara (5) está equipada con un sistema automático que almacena las muestras y las caca una por una, para presen tación al haz de iones.

La posición exacta de una muestra puede ajustarse desde el exterior de la cámora.

Encima de la muestra se coloca una máseara de aluminio cuya apertura define exactamente el área de la muestra que se quiere sujetar a la implantación.

La cámara tiene ventanas que permiten la observación des de cl enterior.

Para poder concoer la dósis de iones que recibe la muestra es necesario poder medir la corriente I de iones en el haz.

180

5.

4.

3.

Esto se logra en forma sencilla por conectar la muestra a tierra (alravós de la cámera) y medir con un electrómetro la corriente electrónica (del orden de microampers) que fluye en el alambre (15) de la conexión.

Puesto que la muestra no adquiere càrga electrostática (si la adquiere, repelería el haz de iones) la corriente de los iones que entra en la muestra, es igual a la corriente electró nica que sale de la muestra a la tierra.

Un ión, por ejemplo de Lantano, incidente sobre la muestra con energía de 250 KeV, se para después de haber entrado a una distancia de 400 Å (en promedio) adentro de la muestra. Puesto que el proceso por el cual se para un ión tiene una naturaleza estadística, en una haz de iones de Lantano, unos iones se pararán en distancias menores de 400 Å y otros en distancias mayores.

6.

a)

b)

El efecto neto del proceso de implantación es producir una distribución gaussiana de Lantano en la muestra, cuyo pico se centra en una distancia de 400 Å adentro de la muestra y cuyo ancho es del orden de 50 Å.

La profundidad de la implantación depende de la energía de los iones al incidir sobre la muestra, por ejemplo, en el caso de los iones de Lantano de energía de 200 KeV, el pico de la gaussiana se encuentra a aproximadamente 300 Å adeo por iones de argón).

El fenómeno llamado "self-sputtering" ocurre cuando el ión que sale disparado de la muestra no es un lón original de la muestra, sino uno de los iones implantados.

La cantidad de material implantado, depende de la corriente en el haz y el tiempo del experimento, en la forma

$N_i = It/q$

En donde N_i es el número total de iones implantados y I es la corriente del haz, t es el tiempo durante el cual el haz está incidiendo sobre la muestra y q es la carga de cada ión.

Esta fórmula desprecia los efectos de self-sputtering. Existe un Finite a la cautidad de material que puede ser im plantada en la muestra, que es del orden de 20-30% (atómico) de la concentración de átomos de la muestra en la región de su superficie.

La cantidad de self-sputtering empieza a sumentarse, hasta que en el línsite la llegada de més iones de la muestra, reculta en nada más que la pérdida de més iones implantados, por el proceso de self-sputtering.

En el caso de las muestras estudiodas en la presente tesis, la cantidad de iones implantados fue por mucho abajo de este Emito, del orden de 0.1% atómico (2X10¹⁶ iones/cm²).

182

b)

a)

8.

dentro de la muestra; una energía incidente de 335 KeV produce el pico en 500 Å.

7.

a)

b)

Al paravse deniro de la muestra un ión ha perdido toda su energía cinética que tenía al incidir en la muestra. Por principio de la Conservación de la Energía, es obvio que la muestra gane una cautidad igual de energía. Una parte de esta energía aparece en forma de calor; otra parte se gasta en la creación de defectos en la muestra. Los defectos producidos se encuentran hasta una profundidad mayor que el alcance de los iones mismos, puesto que muchos de los defectos son producidos por átomos de la mue<u>s</u> tra que han adquirido energía cinética como resuliado de choques sufridos con los iones del haz.

Una excepción a la regla, que la energía perdida por un ión es ganada por la muestra, ocurre en el caso de que el ión transfiere su energía a un ión (o átomo) en la superficie de la muestra, que entences sale disparado de la mue<u>s</u> tra hacia los alrededeves.

Este fonémene, que ce lleura "Sputtering" de la muestra por los iones, representa una ocurrencia no desenda en el proceso de implantación iónica (se aprovacha en sistemas para la producción de polículas delgadas de un metal por "Sputtering" de un blanco del mismo material bajo bombar La cantidad de sputtering fue correspondientemente pequeña. Obviamente, por simple medición de la corriente del haz y del tiempo, es posible controlar en forma muy precisa el $n\underline{u}$ mero de iones implantados.

9.

10.

Por controlar bien las lentes que enfocan el haz y el sistema de barrido, es posible controlar con precisión la uniformidad de la implantación.

Por controlar la energía del haz, se controla la profundidad de implantación de los iones.

En sumario la técnica es la más precisa hasia abora conocida para la introducción de átomos de impurezas adeniro de una muestra.

Inicialmente (1957) se desarrolló la técnica de implantación iónica para la introducción de cantidades controladas de impurezas ou materiales semiconductores durante la fabricación de dispositivos semiconductores.

Su uso se ha extendido al estudio de los metales superconduc tores, a la producción de nuevos catalizadores y a la modificación de materiolos magnéticos, adomás que al problema de corresión.

 En el area de la correctión se aprevecha la técnica para la formación de "ateaciones" de metales cuya composición pue de ser controlada con precisión y que en unos casos sobrepasan los limites naturales de solubilidad de un metal en otro.

Este aprovechamiento tiene dos aspectos, una es a nivel investigueión, como en el caso de las muestras estudiadas en el presente trabajo.

Otra es a nivel producción, en donde la técnica se ha usado para la protección de aceros especiales contra la corrosión; la ventaja del método es que evita los problemas interfaciales asociados con pintura, electrodepósitos, etc.; también afecta únicamente a la superficie del acero dejando sin afectar las propiedades del interior del acero que normalmente son op timas desde el punto de vista del ingeniero.

"APENDICE B"

MEDICION DE ESPESOR DE CAPA DE OXIDO POR REACCION NU-CLEAR INDUCIDA.

1. El equipo usado en esta técnica, es en gran parte idéntica al equipo usado en la ténica de implantación iónica descrita en Apén dice "A", con modificaciones al contenido de la cámara (5) de la fi gura 108 y la eliminación del sistema de barrido. Los experimen tos hechos sobre las muestras de la presente (esis se efectuaron con un sistema para roacción nuclear en donde el generador de alto voltaje era un generador Van der Craaff.

2. Un haz de 1.5 mm, de diámetro de iones de deuterio $(D_2 +)$ de 1.76 MeV se incide sobre la muesira. Los deuterones (de 0.88 MeV) en el deuterio provocan les signientes reacciones nucleares con los núcleos del exigeno presente en la cape de óxido:

a) $0^{16} + d = 20^{17} + p$

b) $O^{15} + d - O^{17} + p$ (es decir, el múcleo de oxígeno se en 2 cuentra al final de la reacción en estado excitado, implicando que las energías de los protonos emitidos serán menores que en el caso de la reacción (a)).

c) $O^{16} + d \rightarrow O^{17} + d$

Para deuterones de una determinada energía al inicio de la reacción, las energías de los protones y partículas que se producen en estas reacciones están determinadas por el principio de conservación de energía.

3. Dispuesto en la cámara se encuentra un detector de partículas las energéticas, sensitivo a las energías de las particulas. Los pulsos eléctricos producidos por los protones y partículas alfa incidentes sobre este detector son amplificados y analizados por un analizador multicanal en un sistema electrónico complejo, haciendo la salida del sistema el número de partículas contadas en función de su energía (es decir un espectro de las partículas emitidas). Para impedir la llegada al detector de electrones secundarios emitidos de la muestra bombardeada (que causarían problemas en la interpretación de los pulsos) se coloca entre muestra y detector un anillo cargado a alto voltaje negativo; este anillo repele los electrones e impide que lleguen al detector.

4. Un espectro típico se muestra en la Fig. 109. Los picos "P1", "P2" y " $_{<\!\!<\!\!<\!\!<\!\!}$ " corresponden respectivamente a los protones emitidos en la reacción (b), los protones emitidos en la reacción -(c), y las partículas e- $\!\!<$ emitidas en la reacción (c). Para las muestras craminadas en las mismas condiciones experimentales --



(corriente total y energía del haz ctc.) el área hajo cualquiera de estos picos es proporcional (con una reservación que se discute después) al mimero de núcleos de oxígeno encontrados por el haz de deuterio en su viaje através de la capa de óxido y por lo tanto al espesor de la capa de óxido en la región de incidencia del haz. (Las dos "muestras" a que se refiere podrían ser, obviamente, dos regiones de la misma muestra).

5. La reservación mencionada es la siguiente:

La probabilidad de commencia de una reacción nuclear dada depende de la energía del deuterio al inicio de la reacción: Esta energía no es necesariamente la misma que la energía de incidencia de los deuterones, porque los deuterones pienden energía en atravesar la capa de óxido. Una dependencia fuerte de este tipo destruiría la base teórica del experimento y la proporcionalidad entre área bajo el pico y espesor de la capa de óxido. En efecto, la reacción -(a) no sufre una tal dependencia para deuterones de energía entre 0.75 MeV y 0.94 MeV (lo que explica la selección -- no aleatoria-- de la energía del bas para proporcionar deuterones de 0.38 -MeV).

Por lo tento el pico P2 se puede usar con confinuza como modida del espesor del óxido. (Los otros picos pierden su interés; en el caso del pico " \sim " hesta se tomaron modidas para reduciv su tamaño, por interponer un filtro de partículas \propto entre la muestra y el detector, para reducir complicaciones en el sistema de detección debidas a un gran número de partículas \ll emitidas).
"APENDICE C"

ELECTROMETRO KEITHLEY 602.

Se presenta una explicación de cómo el electrómetro marca Keithley, Modelo 602, logra ser capaz de medir corrientes tan pequeñas como de 10⁻¹⁵ ampers.

La información viene del instructivo del equipo, pero es típica para electrómetros de este tipo.

En la figura 110 se nota que montadas en la línea central del equipo están dos perillas que ajustan el rango de medi-ción.

La perilla inferior lleva posiciones de 10^{-1} ampers a 10^{-11} ampers (en pasos de un factor de 10^{-1}); la perilla superior lleva posiciones denotadas "10" hasta "0.001".

La lectura de la escala completa del equipo corresponde al producto de las posiciones de las perillas, siendo entonces - 10^{-11} ampers X 0.001 = 10^{-14} ampers en el rango más -- sensible.

3.

1.

El equipo funciona en esencia por introducir en el circuito (en el cual fluye una corriente que se desea medir) una resistencia R de valor conocido y por medir el voltaje V producido através de esta resistencia.

La corriente i se calcula por la ley de Ohm.. i = V/R. La perilla inferior seleccionará cual resistencia se introduce en el circuito.

4.

5.

6.

Con la perilla puesta en 10^{-n} ampers se introduce en el circuito una resistencia de 10^{n} ohms.

La carátula del equipo es simple y sencillamente la de un voltimetro que mide el voltaje generado através de la resistencia mencionada.

Este voltimetro tiene rangos de 10 volts hasta 0.001 volts - (escala completa).

La perilla superior selecciona el rango de este voltimetro. (Se nota que los números corresponden a los antes mencionados).

La operación del equipo puede ser aclarada ahora por medio de un ejemplo; supongamos que el valor de la corriente que se desea medir es de 3.6 X 10^{-9} ampers; la perilla inferior está en " 10^{-5} ampers" y la perilla superior en "0.001". El equipo entonces está mostrando el voltaje generado através de una resistencia de 10^5 ohms, siendo la lectura de la escala completa igual con 0.001 volts. Por la ley de Ohm la lectura es $3.6 \times 10^{-9} \times 10^5 = 0.36$ X 0.001 volt, es decir 0.36 de la escala completa.

Pero desde el punto de vista del operador esta lectura de -

"0.36" significa 0.36 X 10⁻⁵ X 0.001 = 3.6 X 10⁻⁹ ampers, lo que es el valor correcto de la corriente.

Antes de detallar los aspectos del equipo que hacen posibles estas mediciones, cabe indicar una precaución necesaria en su uso.

7.

Es obvio, que la medición de la corriente no será la correcta a menos de que la resistencia interna del equipo sea mucho menor que la resistencia del circuito en que fluye la corriente; es decir, la resistencia R de 10ⁿ ohms que el equipo introduce en el circuito debe ser mucho menor que la re sistencia S del circuito exterior al equipo.

Consideremos como ejemplo, un caso en que el voltaje aplica do al circuito exterior es del orden de 1 volt y su resistencia (S) es del orden de 10^m ohms; entonces la corriente que se desca medir será del orden de 10^{-m} ampers. Si la perilla superior está en "0.001" la perilla superior es tará en 10^{-(m-2)} ampers, para que la escala completa sea 10 X 10^{-m} ampers.

En este caso la resistencia R introducida en el circuito por el equipo es de 10^{m-2} ohms, menor por un factor de 100 que la resistencia S y por lo tanto despreciable. Pero hay que notar que si la perilla superior fuera puesta en "10" entonces la resistencia R sería de 10^{m+2} ohms, - cien veces mayor que la resistencia 5, siendo el resultado totalmente erróneo.

Pero si el voltaje aplicado al circuito exterior es mayor de 1 volt, este problema de resistencia interna es menor; por e-jemplo, con 10 volts en el circuito exterior sería aceptable tener la perilla superior puesta en 0.01.

Correspondientemente si el voltaje en el circuito interior fue ra de 0.1 volt la resistencia R sería del orden de 10^{-1} S aún con la perilla superior puesta en "0.001".

De ésto se obtienen dos conclusiones (1) la perilla superior debe estar puesta en "0.001" para mediciones de corriente -(se incluye esta perilla porque el mismo equipo puede ser usado para medir voltaje), (2) la medición correcta de corrien te necesita que el voltaje aplicado al circuito exterior sea de por lo menos 0.1 volt (en cuyo caso el efecto de resistencia interna es de un 10%) o mejor, de por lo menos 1 volt (con efecto de resistencia interna menor que 1%).

Finalmente llegamos al grano ¿ Cómo se puede construir un voltimetro con resistencia interna mayor de 10¹³ ohms ?. Un voltimetro con tanta resistencia interna se logra gracias a la técnica de los transistores MOSFET (de efecto de campo).

En la figura 111 se muestra en forma diagramática un tran-

sistor de este tipo.

El semiconductor es normalmente de poca conductividad; pero al aplicar un voltaje al contacto de la compuerta G, se produce un campo eléctrico en el óxido que atrae electrones des de el interior del semiconductor; estos forman un canal conductivo en la superficie del semiconductor.

Por lo tanto el voltaje en G modula la corriente que fluye en tre las otras dos terminales (S y D).

El único aspecto importante de este transistor, para fines de nuestra explicación, es el hecho de que la compuerta G está aislada del resto del transistor; una capa de óxido de silicio (SiO₂); el transistor funciona con corriente esencialmente cero en la compuerta.

Aunque la capa de óxido es delgada (del orden de 1 micra de espesor) el óxido de silicio es un aislante tan bueno que la re sistencia de la capa puede alcanzar valores de 10¹⁴ ohms. Para la entrada del voltimetro se elige entonces la compuer ta de un tal transistor, solucionando así el problema de la resistencia interna.

El transistor sirve como la primera etapa de un amplificador que amplifique el voltaje hasta un punto en donde puede ser desplegado por un medidor convencional de hierro móvil. Cabe mencionar que las resistencias del electrómetro contro ladas por la perilla inferior tiene que ser de suma precisión, puesto que cualquier error en su valor se refleja por definición en el valor de la corriente medida.

9.

La fabricación de resistores de tanta precisión es difícil, so bre todo en el caso de resistores de 10⁸ - 10¹¹ ohms. Para mejorar la estabilidad, estos resistores de altos valores vienen en el electrómetro sellados en vidrio. Pero aún así están sujetos a variación de su valor con el tiempo (desplazamiento) y deben ser reemplazados en intervalos menores de un año.



"TABLAS"

TABLA 1.

En la presente tabla, se muestran algunas de las propiedades de los óxidos con los que se trabajaron. (Cr₂0₃ y Cr0₃).

TABLA 2.

Las muestras estudiadas en el presente -

trabajo, con datos sobre el elemento implantado ⁽³⁾.

TABLA 3. -

La proporción entre las "resistividades"-

de las capas de óxido, fuera y dentro de la región implantada para cada muestra estudiada en el presente trabajo; la forma de calcular estas "resistividades" se describió en el Capítulo VI.

	2	è	5		1	ç	2	3	9	ξ,	i,	h	ŝ			e.	Ĩ	ì	2	2	1	ž	Ċ	5	P	ł	Ş	ļ	Ś)	2	ł	Ģ	ł	Ċ,		5	ŝ	ç	j	ć,		ŝ	ļ	ï	2	ŝ	ŝ		5	b	ż	š		ŝ	S	ł	ę	ł.	ą	Ë	ŝ	F.	e	Ņ	g	ź	¥	2	į
ŕ		b	ø	ŝ	Ċ	ľ		λ,	ŝ.	ê	÷	ł	ŝ	ĩ,		ē	2	1		٢	Ŷ	Ņ	ç		3	í,	ŝ	1		ç	S	5	2	2	h	Ğ	÷	Y	ć	ł	5	2	ę	ŝ	ā	5		Ē	ì	ĕ,	k	2	5	ŝ,	, b	ĉ	ĥ	à	ē.	ş	ŕ,	2	ï	2	ð	i.		h	ł	l
		ý	ŝ,	ć	2						3	ŝ			j	١,	í.	÷	S	đ		2	ŝ	ţ	Ż	;		í.	ŝ	ŝ	è	3			÷		č,	f	÷	i,	a	ĉ	à	ľ	÷	ł	ĝ	1	ŝ		Ż	è	ē	늺	£	ŝ	÷	ž	5	ā	2	ĥ	7		ł	c	i,		ł	i

SAMSONOV, THE OXIDE HANDBOOK, PLENUM PRESS, (1973)

- HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS CRC PRESS. (1975-1976)
- 9.2 CONSTANTE DIELECTRICA .
- PUNTO DE EBULLICION BANDA PROHIBIDA , E 10¹⁹ J⁻¹ 7.68
- 2,573°C PUNTO DE FUSION 4,000°C
- INDICE DE REFRACCION DENSIDAD ESPECIFICA
- hexagonal ESTRUCTURA 2.551
- verde COLOR
- PESO MOL
- COMPUESTO
- Cr203

151.99

5.21

Cr03

99.99

café rojizo

rómbico

2.70

delicua

460°C

			ELECTRONEG	CALOR DE A FORMACION	POTENCIAL	PESO
MPLANTACION.	VALENCIA.	RADIO IONICO.	TIVIDAD.	DEL OXIDO.	DE OXIDACION	ATOMICO
Cd X ₁₅	2	1.14	1.5	-630,000	0.40	112.40
Al $X_{e} X_{11} X_{10}$	3	0.51	1.5	-404,100.	1.66	26.98
0 11 19 31 Xe	4	0.42	1.8	-209,000		28.08
La Xin	2	1.14	1.1		2.52	138.91
re V10	4	o.78	1.4	-268,380	1.7	178-50
	3,4	1.07, 0.94	1.1	-435,600	2.48	140.3
	3, 4	1.06, 0.92	1.1	-440,600		140.9
6 -7 34 V- V	3		1.2	-435,150 ∽	2.44	144.3
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2, 3	1.00	1.2	-430,600	2.41	180.5
···· ·6 ·8	2, 3	0.98	1.1		alt a start of the second s	
11 24 V.	3	0.62	1.2		2.40	187.
HE S	3	. 0.92	1.2			162.
	• 3	0.91	1.2			164.4
*** * 1 Fm V_	3	0.89	1.2			167.
~~• '5 Tm T	3	0.86	1.2	4		168.
••••• ~15 Tu V.	3	0.85	; 1.2		2.25	174.
Lu Vl Ro Vio	2	1.53	3 0.9	-134,600	2.90	137.

CONTINUACION

"TABLA 2."

UNIDADES.

Radio Iónico

Electronegatividad

PAULING

Calor de Formación del óxido

Kcal/mol

Potencial de oxidación

Volts

"TABLA

MUESTRA	তা /্যর		تم
V	0.83	0.36	
v1	9 12	0.00	
v2 v	10.63	0.34	
v^3	1.43	0.33	
'4 v	6.32	0.32	
v5	4.46	0.25	
V ₇₇	5.55	0.33	
Vo	0.58	0.34	
Vo	0.30	0.22	
v.	22.00	0.49	an a
V11	13.35	0.62	
V16	• 2.5	0.36	
L	0.77	0.41	
L	0.076	0.07	
L ₇	0.89	0.46	1913 - 1914 1914 - 1914 1917 - 1914
Lo	0.56	0.32	
L ₁₅	1.03	0.10	
		다는 것은 가슴을 통하는 것을 가지. 같은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 통하는 것은 것을 통하는 것은 것을 통하는 것을 통하는 것을 통하는 것을 받았다. 같은 것은	
	0.51	0.97	
X ₆	2.8		0.37
	3.87	8.24	
	92.81	0.88	
X ₁₀	38.3	이 성의 것은 것이 같은 것이 가지 않는다. 이 것이 있는 것이 같은 것이 있는 것이 있는 것이 있다. 같은 것이 있는 것이 같은 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같이 않는다. 것이 같은 것이 있는 것이 같은 것이 없는 것이 같은 것이 없는 것이 없는 것	0.14
•	0.48	0.15	
	13.7	1.18	A 4A
X ₁₁	1.7		0.18
	0.036	0.17	
	3.02	0.90	0.94
×15	42.76	Δ ΠΟ	U. 31
	21.54	0.23	그 나는 것은 물건을

"REFERENCIAS"

- (1) Z. M. Jarzebski; Oxide Semiconductors, (Pergamon Press, 1972).
- (2) E. A. Gulbransen and K. F. Andrew, J. of Electrochem, Scc 99 No. 10, 1952, P 402
- (3) G. Dearnaley J. H. Freeman, R. S. Nelson and J. K. Stephens Ion Implantation (North-Holland, Co.).
- (4) S. Muhl. R. A. Collins and G. Dearnaley, Inst. Phys. Conf. -Ser. No. 28 Cop. 4 (1976).
- (5) S. Muhl. Msc. Thesis, University of Lancaster.
- (6) S. Muhl. PhD. Thesis, University of Lancaster.
- (7) K. R. Lowless. Rep. on Prog. in Phys. 37 No. 2, 1974.
- (8) D. N. Butcher, Msc. Thesis (1974) Brigmton Polytechnic.
- (9) S. Brunaver. The Adsortion of Gases and Vapors. Vol. I --(Princeton University Press, Princeton N.d 1943).
- (10) P. Kofstad, High-Temperature of Metals. (J. Wilfy, y Sons).
- (11) Charles Kittel. Introducción a la Física del Estado Sólido. Cap.
 19, (Reverte. 1975 2a. Ed.).
- (12) Vaan Gool. Principles of Defect Chemistry. (Academic Press 1976).
- (13) Hermann Schmalzried. Solid State Reactions. (Academic Press 1974).
- (14) Charles Kittel. Introducción a la Física del Estado Sólido. Cap. 20, (Reverte. 1975 2a. Ed.).
- (15) G. Dearnaley and N. E. W. Hartley. AERE Harwel. Rep. --(1976) R 8562.

(16) D. J. Young, and M. Cohen, J. of Electrochem. Soc. 124 --No. 5 (1977) P. 769

(17) J. G. Simmons and R. R. Verderber, Proc. Roy. Soc. A 301 (1976 a) 77 - 102.

(18) N. F. Mott, Phil. Mag. 17 (1968 a) 1259 - 68).

(19) G. G. Winner J. C. Reruchetti, A. Jaegle and A. Karl, Surfaces. Science 78 (1978) 439 - 458.

(20) Comunicación Privada, con Dr. G. Jones.